

21. Seminar Optične Komunikacije

Laboratorij za Sevanje in Optiko

Fakulteta za Elektrotehniko

Ljubljana, 5. - 7. februar 2014

# Svetlobni sprejemnik

Matjaž Vidmar

..... Seznam prosojnic: .....

Slika 1 - Optične komunikacije v zrelih letih

Slika 2 - Kam pes taco moli?

Slika 3 - Fizika in merske enote

Slika 4 - Zvrsti svetlobnih sprejemnikov

Slika 5 - Režim delovanja fotodiode

Slika 6 - Zgradba PIN fotodiode

Slika 7 - Odzivnost PIN fotodiode

Slika 8 - Shannon-ov izrek o zmogljivosti zveze

Slika 9 - Spektralna gostota šuma

Slika 10 - Toplotni in zrnati šum

Slika 11 - Šum sprejemnika s PIN diodo

Slika 12 - Razmerje Q in pogostnost napak

Slika 13 - Domet PIN sprejemnika

Slika 14 - PON razvod s PIN sprejemnikom

Slika 15 - Svetlobni sprejemniki z ojačanjem

Slika 16 - Fotodioda s plazovnim ojačanjem (APD)

Slika 17 - Lastnosti APD sprejemnika

Slika 18 - Domet APD sprejemnika

Slika 19 - PON razvod z APD sprejemnikom

Slika 20 - Izvedba preprostih sprejemnikov

Slika 21 - PIN na potujoči val (TW-PIN)

Slika 22 - Svetlobni predajačevalnik

Slika 23 - Diferencialni PSK sprejemnik

Slika 24 - Koherentni sprejemnik

Slika 25 - Balančni sprejemnik

Slika 26 - Kvadraturni sprejemnik

Slika 27 - Sukanje kazalca/vektorja

Slika 28 - Dvopolarični sprejemnik

Slika 29 - Stopnje regeneracije sprejema

Slika 30 - Izvedbe zvez

Dve desetletji seminarjev Optične komunikacije - kaj se je spremenilo?

Nekoč (pre)velika pričakovanja brez inženirske utemeljenosti:

...pred dobrim desetletjem se je "optični balon" razpočil...

Znanstvena odkritja —————> inženirske rešitve!

Laboratorijski poskusi —————> zahteve standardov!

Fizikalna izvedljivost —————> ekomska upravičenost!

Fizikalne merske enote —————> inženirske merske enote!

Razvoj drugih področij telekomunikacij: stroge OSI ravni protokolov!

---

Potreba po preglednih predavanjih o ključnih tehnologijah: tutorial!

Elektronika je cenejša in zmogljivejša tehnologija od mehanike (MEMS), akustike (piezoelektrični), mikrovalov, optike, atomskih ur itd.

Silicij je cenejši in zmogljivejši od III-V polprevodnikov.

Številska (digitalna) obdelava signalov je cenejša in zmogljivejša od analogne obdelave signalov.

Optični tranzistor, optični računalnik niti druge uporabne tehnologije optične obdelave signalov zaenkrat NE obstajajo.

Paketni prenos je cenejši in učinkovitejši od drugih vrst prenosa.

Združljivost zahteva uporabo sklada IP na višjih OSI ravneh in uporabo Ethernet standardov na nižjih OSI ravneh.

Nespoštovanje OSI ravni oziroma krpanje nezdružljivih (nepotrebnih) protokolov vodi v katastrofo.

V telekomunikacijskem sprejemniku so signali najšibkejši v celotni zvezi.  
V svetlobnem sprejemniku pride najprej do izraza zrnati (kvantni) značaj elektromagnetcnega valovanja:

$$W_f = h\nu = \frac{hc_0}{\lambda} \equiv \text{energija fotona}$$

$\nu$  [Hz]  $\equiv$  frekvenca svetlobe

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \equiv \text{Planck - ova konstanta}$$

V področju svetlobnih frekvenc je praktična merska enota za energijo fotona elektronski volt [eV]:

$$W[\text{eV}] = \frac{1}{|Q_e|} \cdot W[\text{J}]$$

$$Q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$$

$$W_f[\text{eV}] = \frac{hc_0}{\lambda[\mu\text{m}]}$$

$$h \cdot c_0 = 1.24 \text{ eV} \cdot \mu\text{m}$$

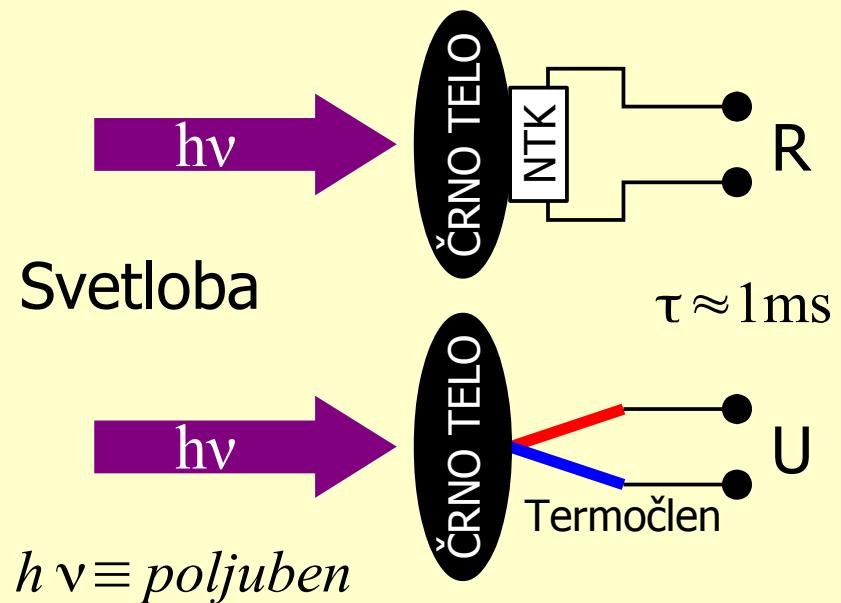
Toplotna energija:

$$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K} \quad T = 293 \text{ K}$$

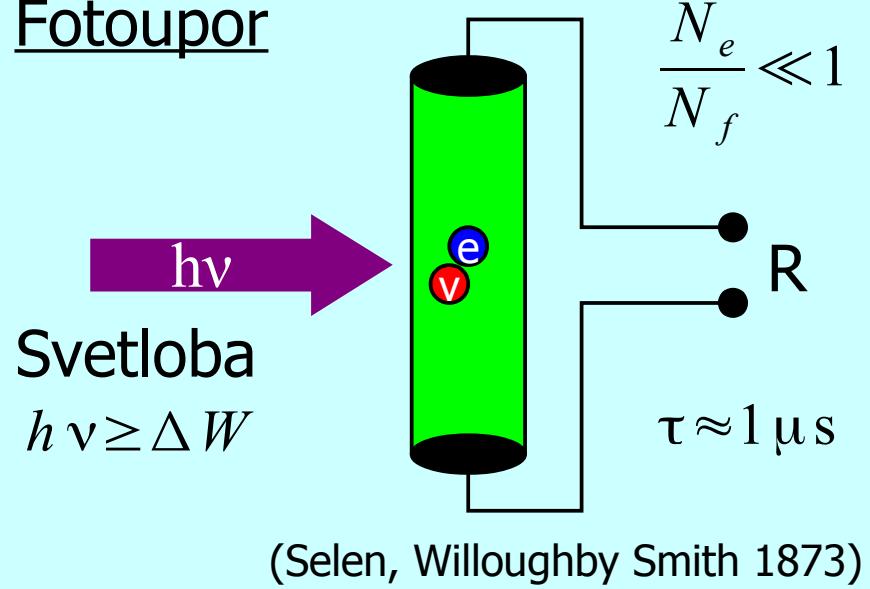
$$W_T = k_B T = 4 \cdot 10^{-21} \text{ J} = 0.025 \text{ eV}$$

Svetloba	Območje $\lambda$	Območje $W_f$	Primerjava $W$
Vidna	400nm...700nm	3.1eV...1.7eV	$W_f \gg W_T$
Bližnja IR	800nm...2μm	1.5eV...0.6eV	$W_f > W_T$
Toplotna IR	3μm...100μm	0.4eV...0.012eV	$W_f \approx W_T$

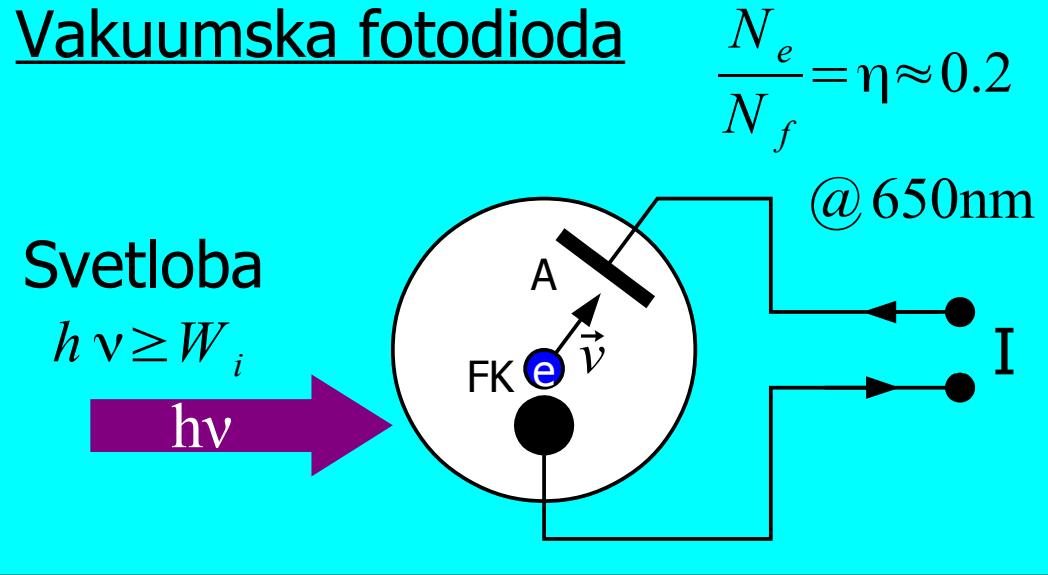
## Toplotni sprejemnik



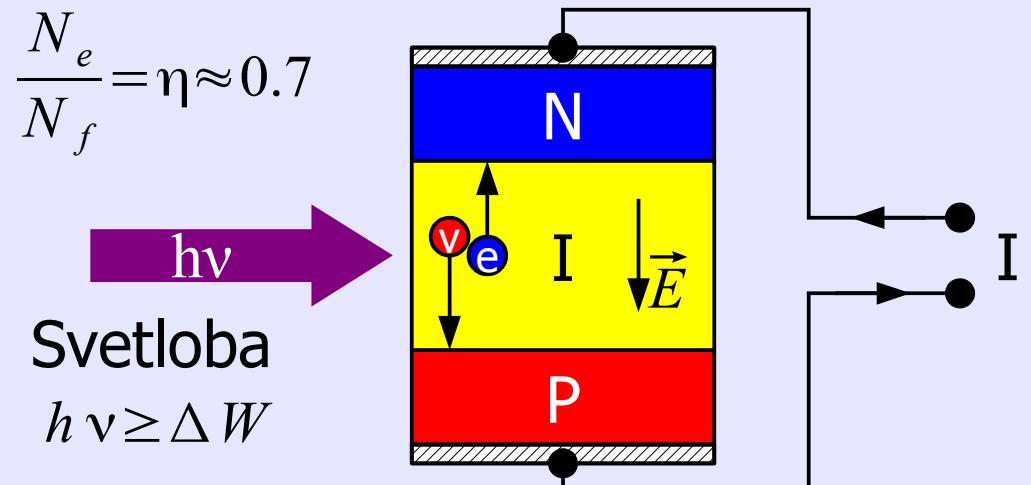
## Fotoupor



## Vakumska fotodioda



## Polprevodniška fotodioda



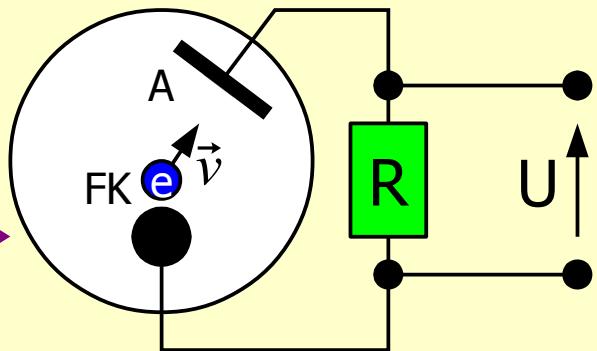
$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \equiv \text{Planck - ova konstanta}$$

$$W_f = h\nu \equiv \text{energija fotona}$$

## Fotovoltaični režim

Svetloba

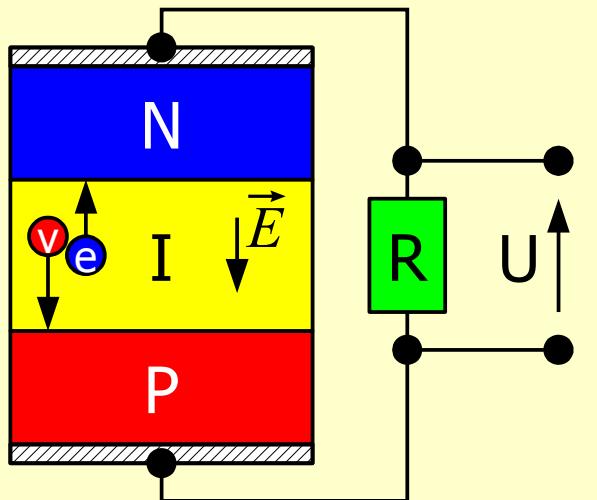
$$h\nu \geq W_i$$



Pretvorba svetlobne moči v električno...

Svetloba

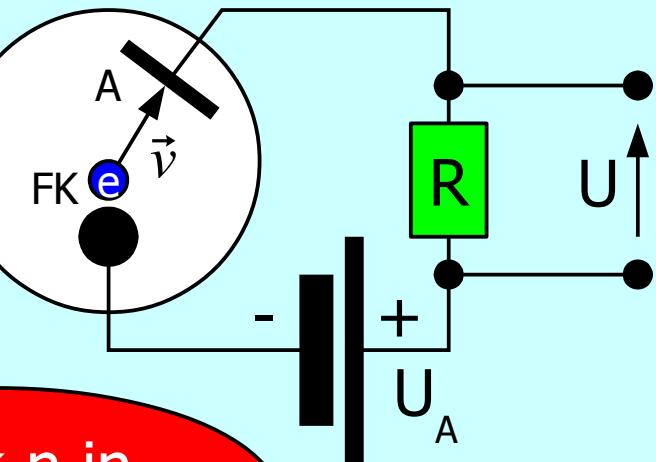
$$h\nu \geq \Delta W$$



## Fotouporovni režim

Svetloba

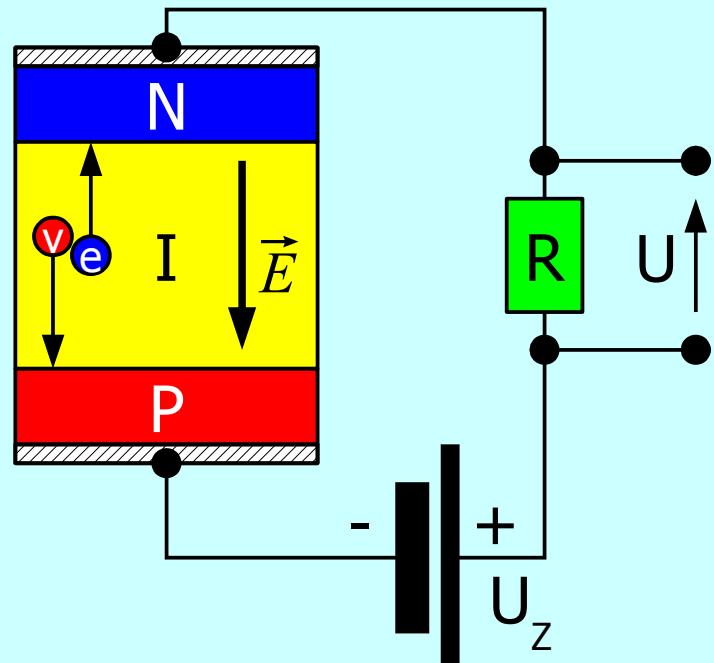
$$h\nu \geq W_i$$



Visok  $\eta$  in hiter odziv...

Svetloba

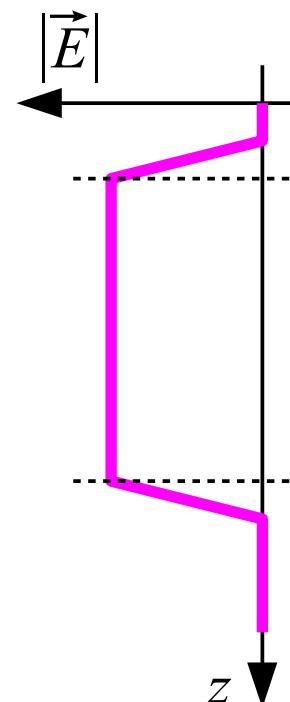
$$h\nu \geq \Delta W$$



$$h \cdot c_0 = 1.24 \text{ eV} \cdot \mu \text{m}$$

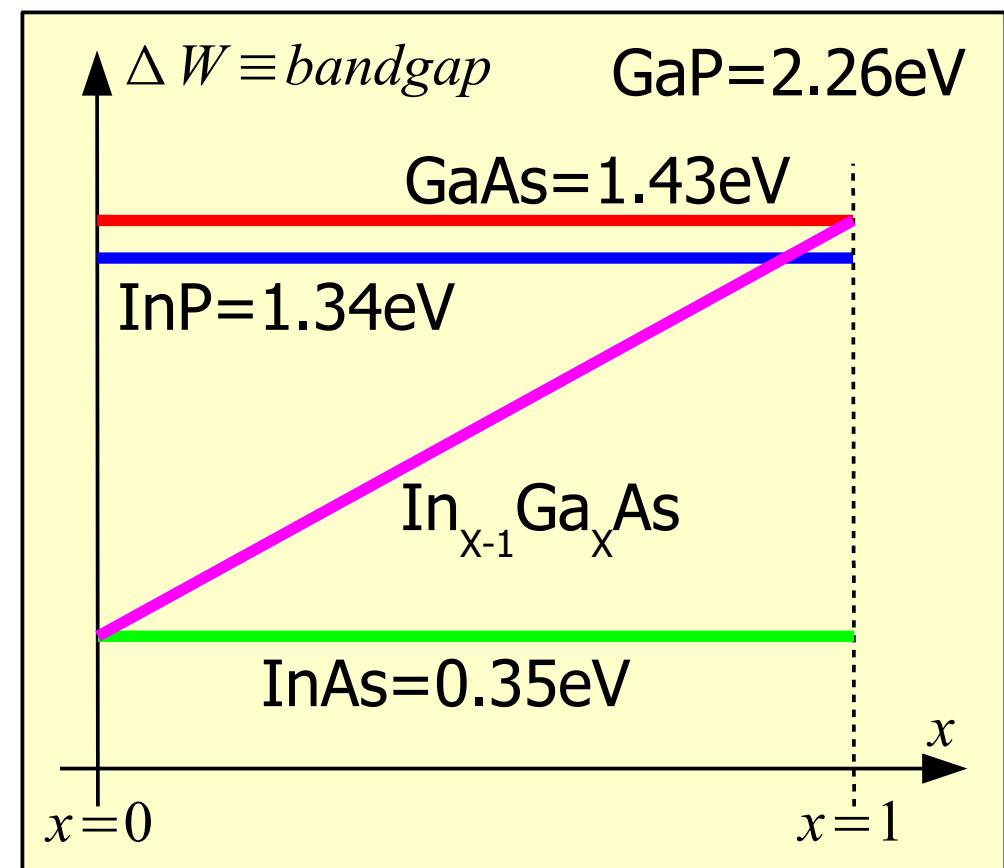
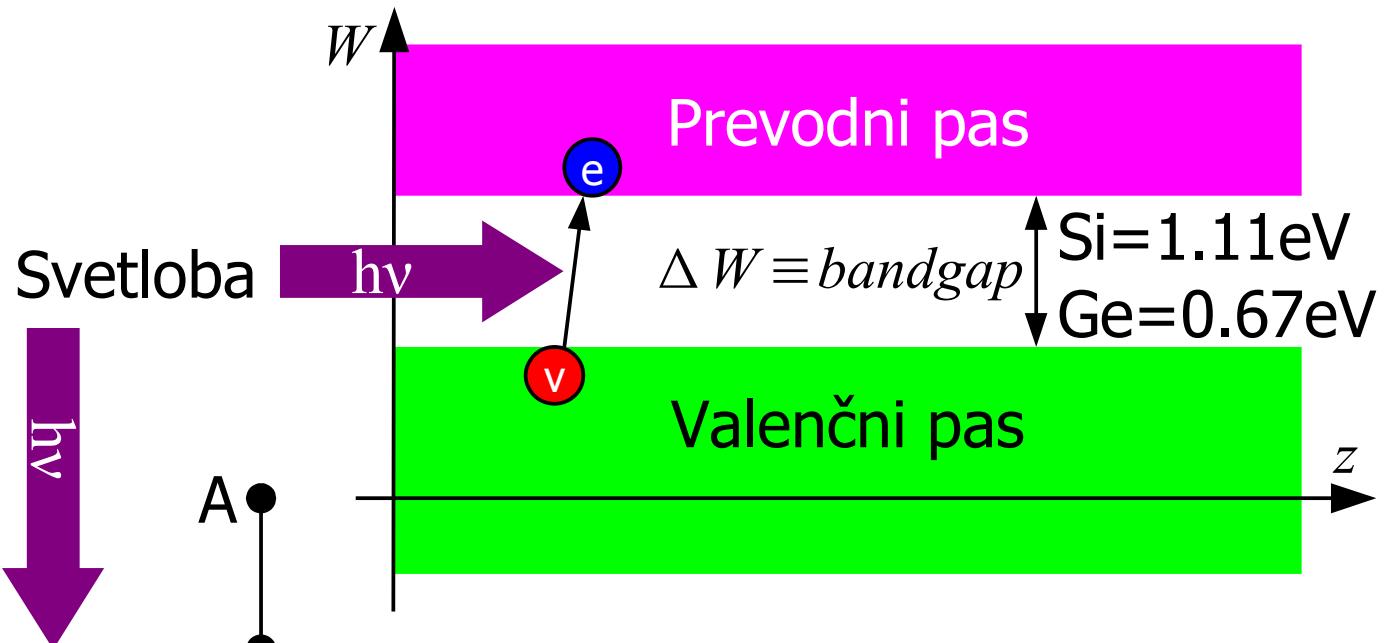
$\lambda$	$h\nu$
$0.85\mu\text{m}$	$1.46\text{eV}$
$1.31\mu\text{m}$	$0.95\text{eV}$
$1.55\mu\text{m}$	$0.80\text{eV}$

$$\Delta W_{InP} > h\nu > \Delta W_{InGaAs}$$

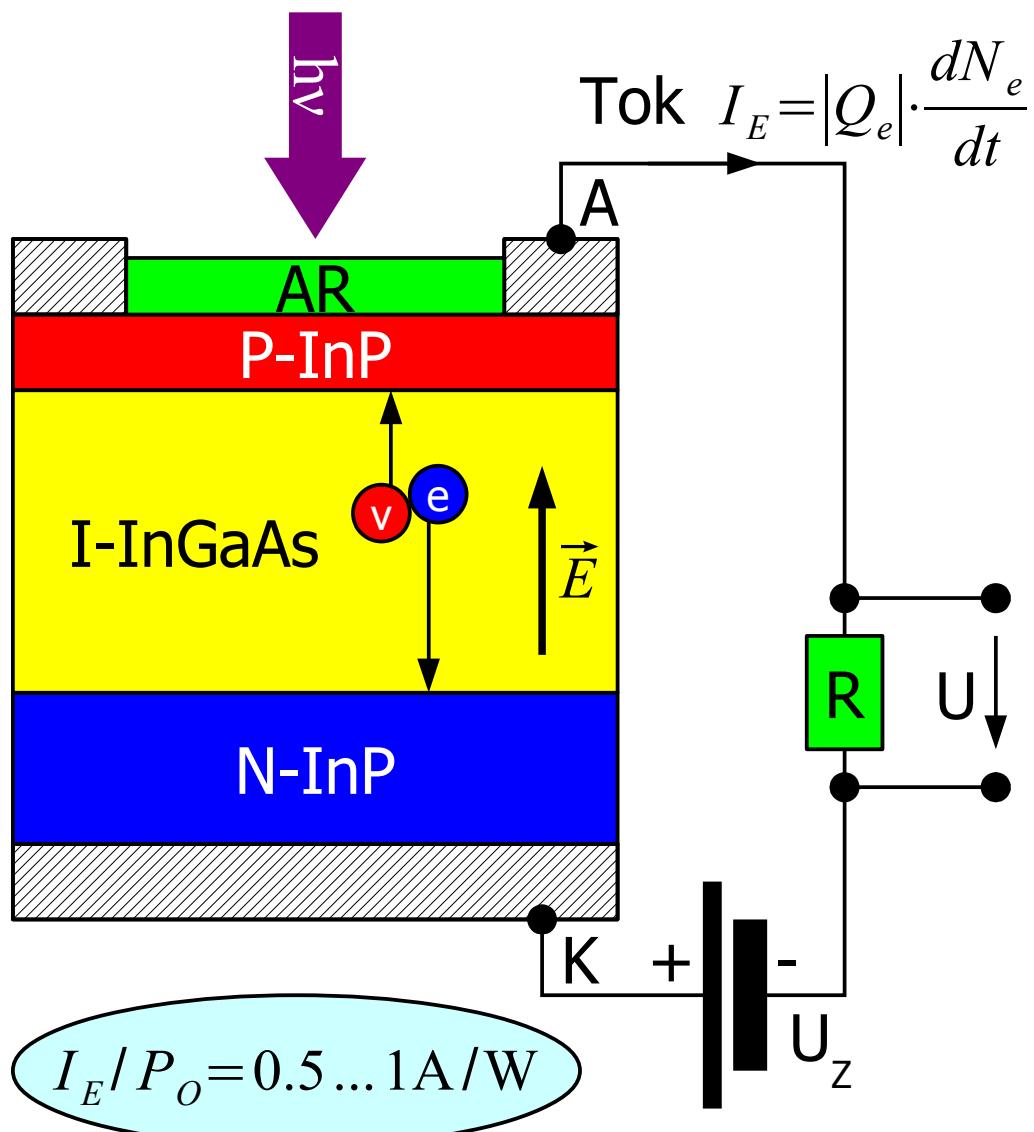


Heterostruktura InGaAs/InP

## 6 - Zgradba PIN fotodiode



Svetlobna  
moč  
 $P_o = h\nu \cdot \frac{dN_f}{dt}$

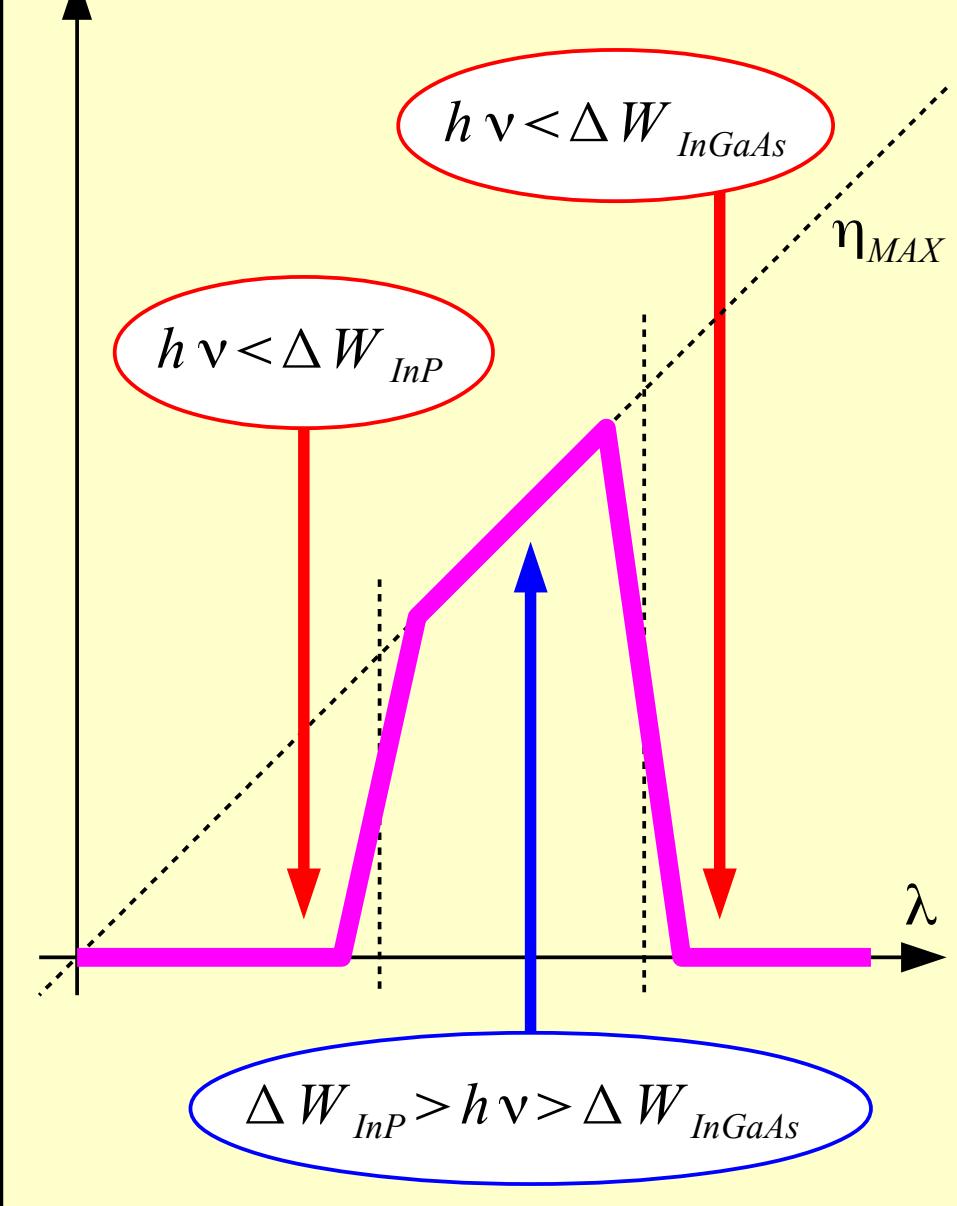


## Kvantni izkoristek

$$\eta(\lambda) = \frac{N_e}{N_f} \quad \eta_{MAX} \approx 0.7$$

## Odzivnost

$$I_E/P_o \left[ \frac{\text{A}}{\text{W}} \right] = \frac{N_e |Q_e|}{N_f h\nu} = \eta(\lambda) \cdot \frac{|Q_e| \lambda}{h c_0}$$



Informacija

$$I[\text{bit}] = \frac{1}{2} \cdot \log_2 \left( 1 + \frac{W_s}{W_N} \right)$$

Pasovna širina

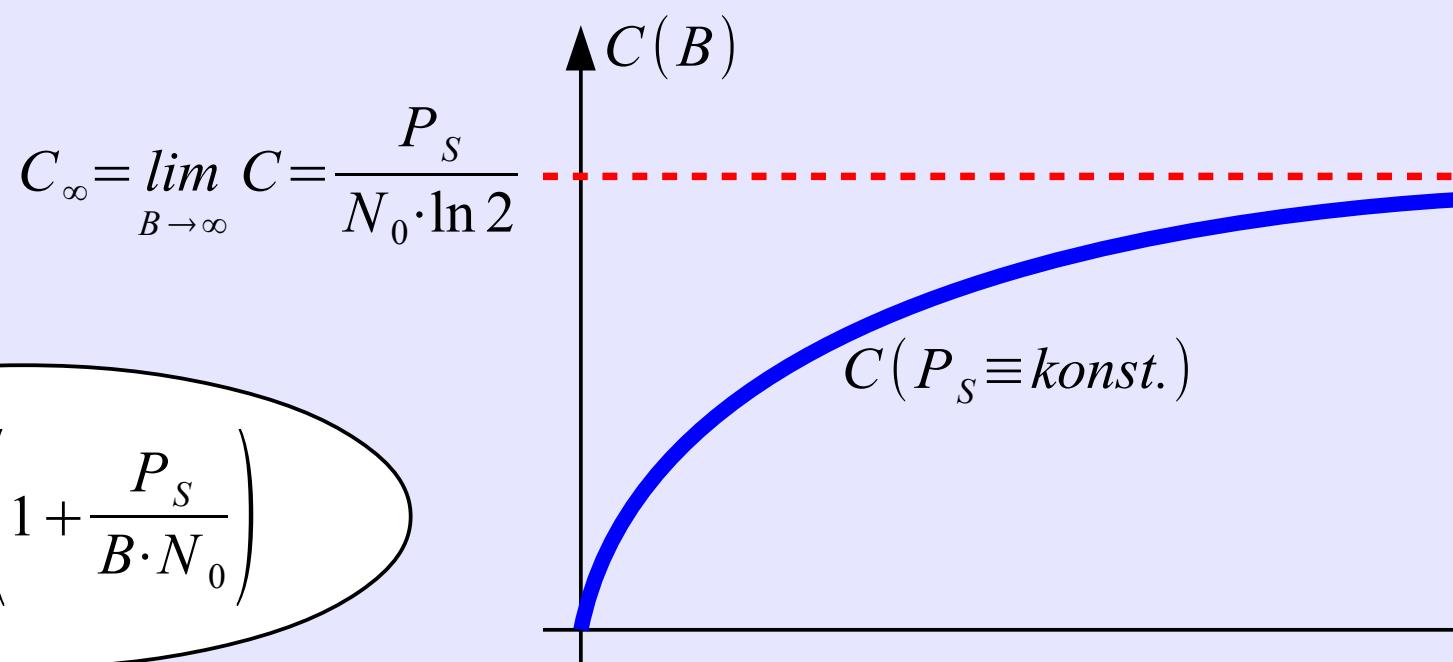
$$B = \frac{1}{2 \cdot T_{\text{bit}}}$$

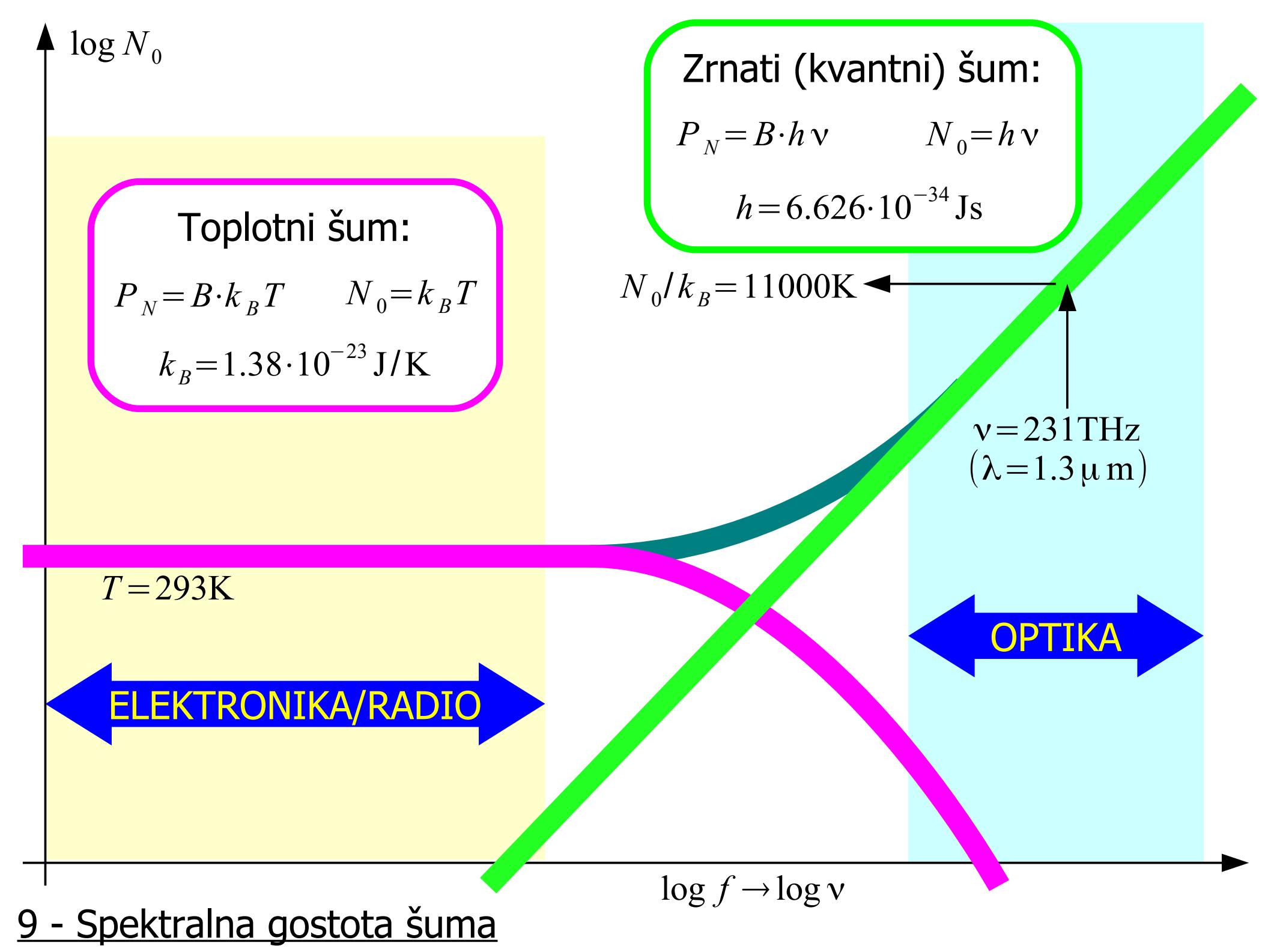
Zmogljivost

$$C[\text{bit/s}] = \frac{dI}{dt} = B \cdot \log_2 \left( 1 + \frac{P_s}{P_N} \right)$$

Moč šuma

$$P_N = B \cdot N_0$$





$U(t)$ Sporočilo brez šuma

0 0 1 0 1 1 0

 $t$  $U(t)$ Samo zrnati šum

0 0 1 0 1 1 0

 $t$  $U(t)$  $\sigma = \sqrt{N}$ Samo topotni šum

0 0 1 0 1 1 0

 $N$  $t$  $U(t)$ Topotni in zrnati šum

0 0 1 0 1 1 0

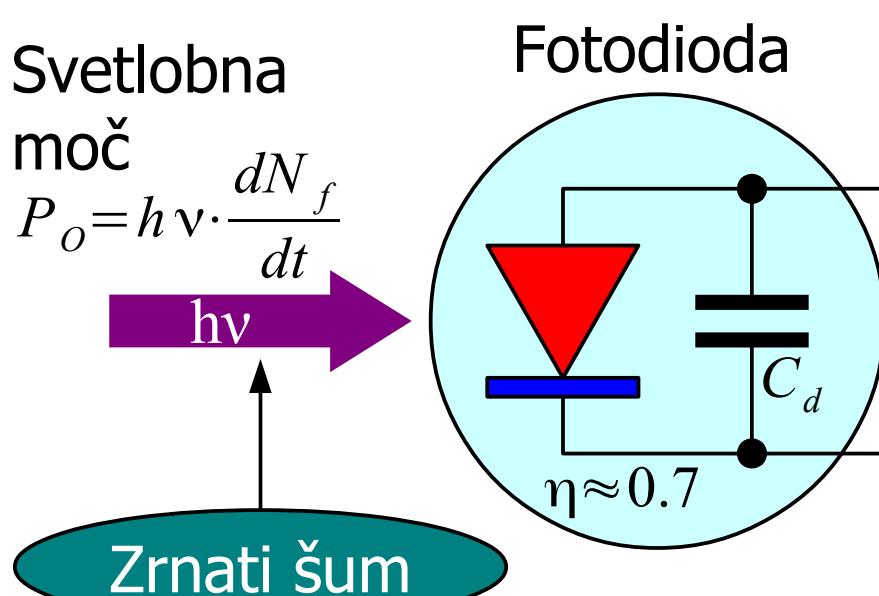
 $t$

Svetlobna moč

$$P_O = h\nu \cdot \frac{dN_f}{dt}$$

$h\nu$

Fotodioda

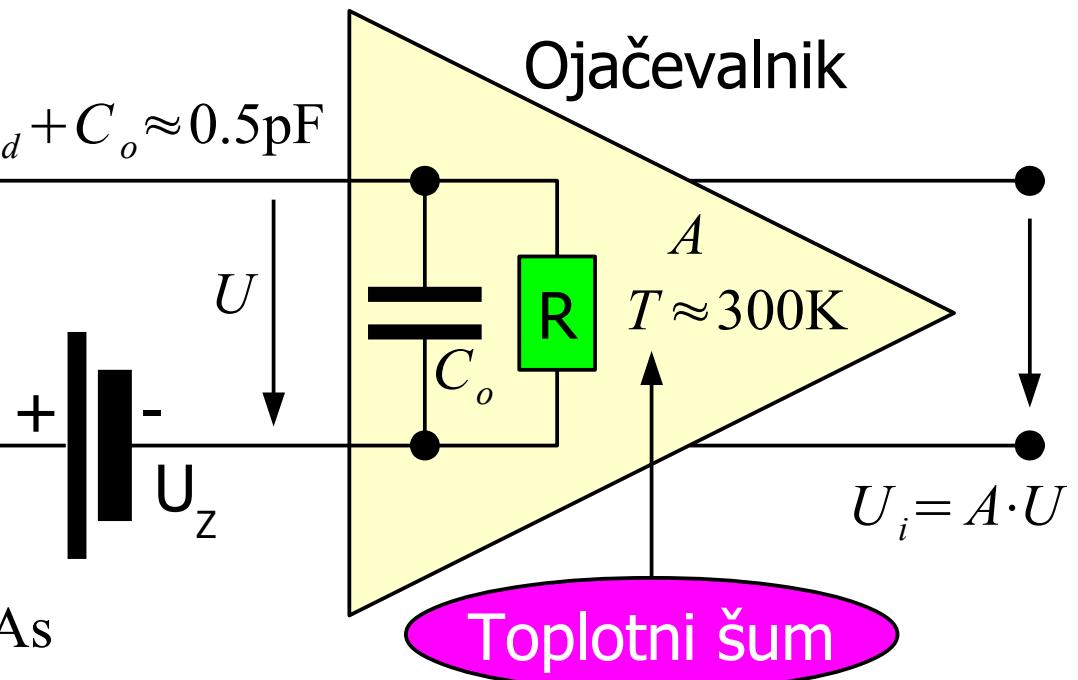


Zrnati šum

$$Q_e = -1.6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$$

$$C_d + C_o \approx 0.5 \text{ pF}$$

Ojačevalnik



Toplotni šum

$$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

$$U_s = \frac{N_e |Q_e|}{C_d + C_o} = \frac{\eta N_f |Q_e|}{C_d + C_o} = N_e \cdot 0.32 \mu \text{V}$$

$$U_{ZRNATI} \approx 0.32 \mu \text{V}_{\text{eff}} \cdot \sqrt{N_e}$$

Toplotni šum ojačevalnika je dosti večji od zrnatega šuma elektronov:

$$B \approx \frac{1}{2\pi R(C_d + C_o)}$$

$$U_{TOPLOTNI} = \sqrt{P_N R} = \sqrt{B k_B T R} \approx \sqrt{\frac{k_b T}{2\pi(C_d + C_o)}} \approx 36 \mu \text{V}_{\text{eff}}$$

$$Q = \frac{\langle U_1 \rangle - \langle U_0 \rangle}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

$$\sigma_1 \approx \sigma_0 \approx 36 \mu V_{\text{eff}}$$

$$BER = \frac{1}{2} \cdot erfc \left( \frac{Q}{\sqrt{2}} \right)$$

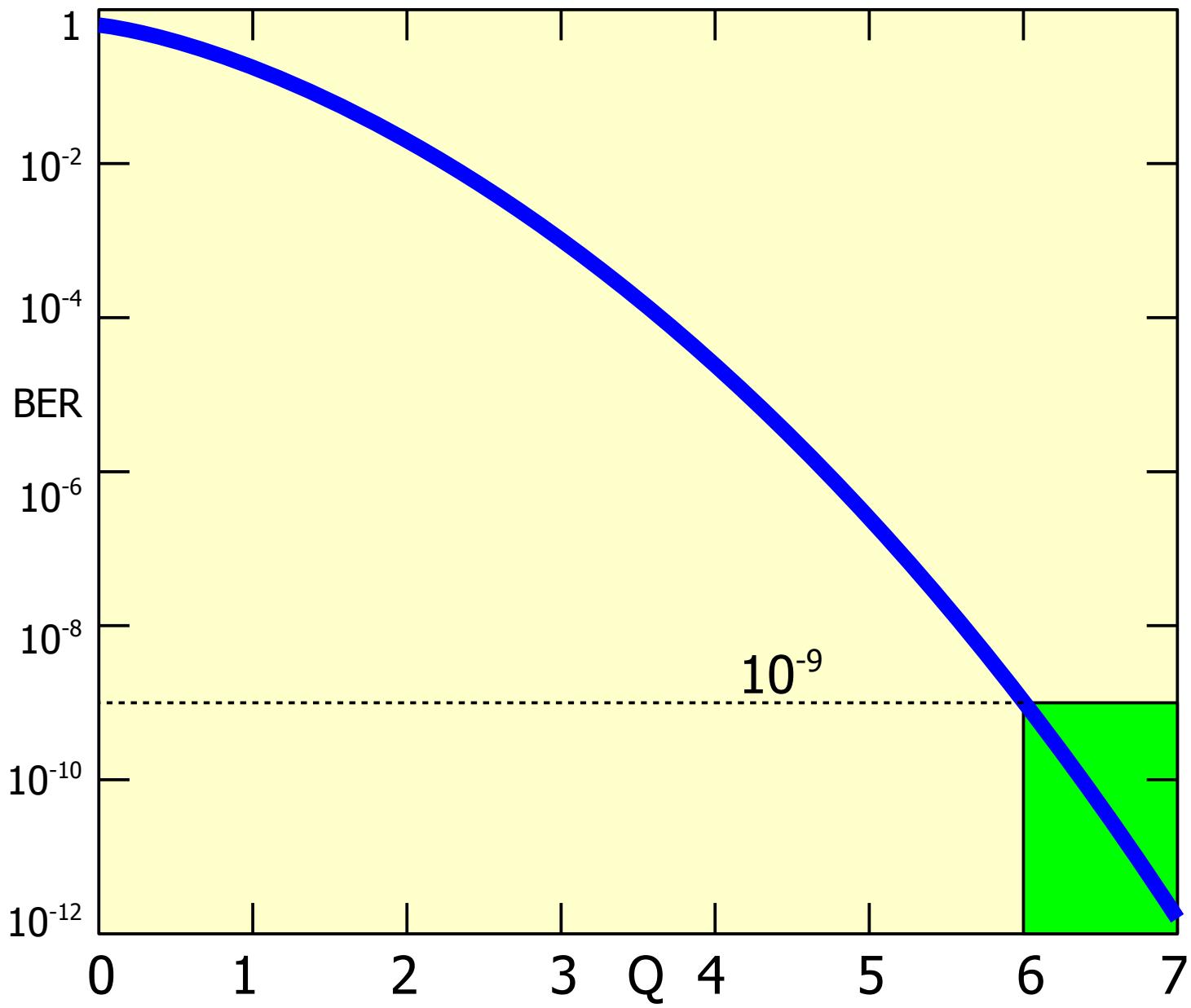
$$Q \approx 6 \dots 7$$

$$U_S \approx 450 \mu V$$

$$enica \rightarrow N_e \approx 1400$$

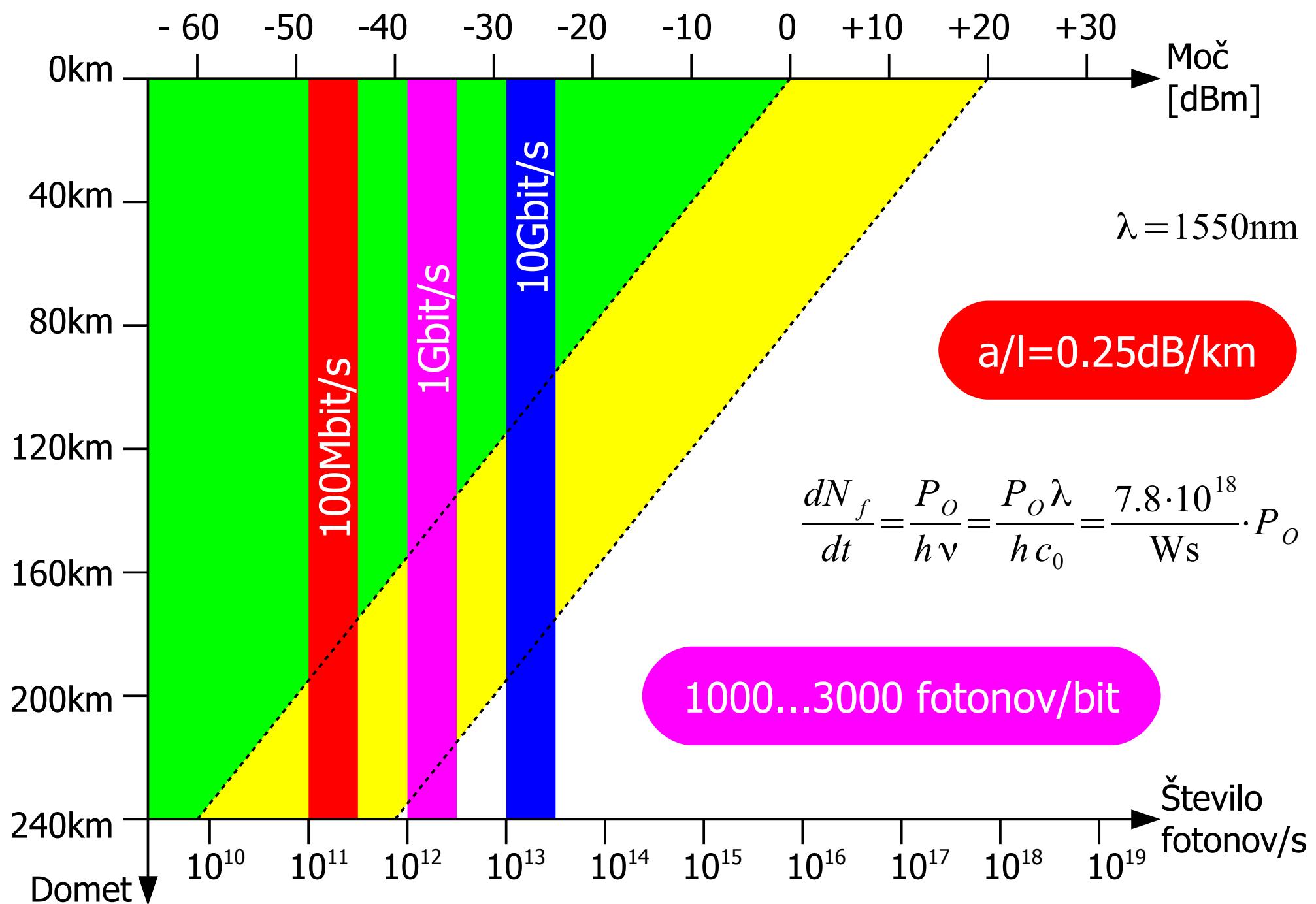
$$\eta \approx 0.7$$

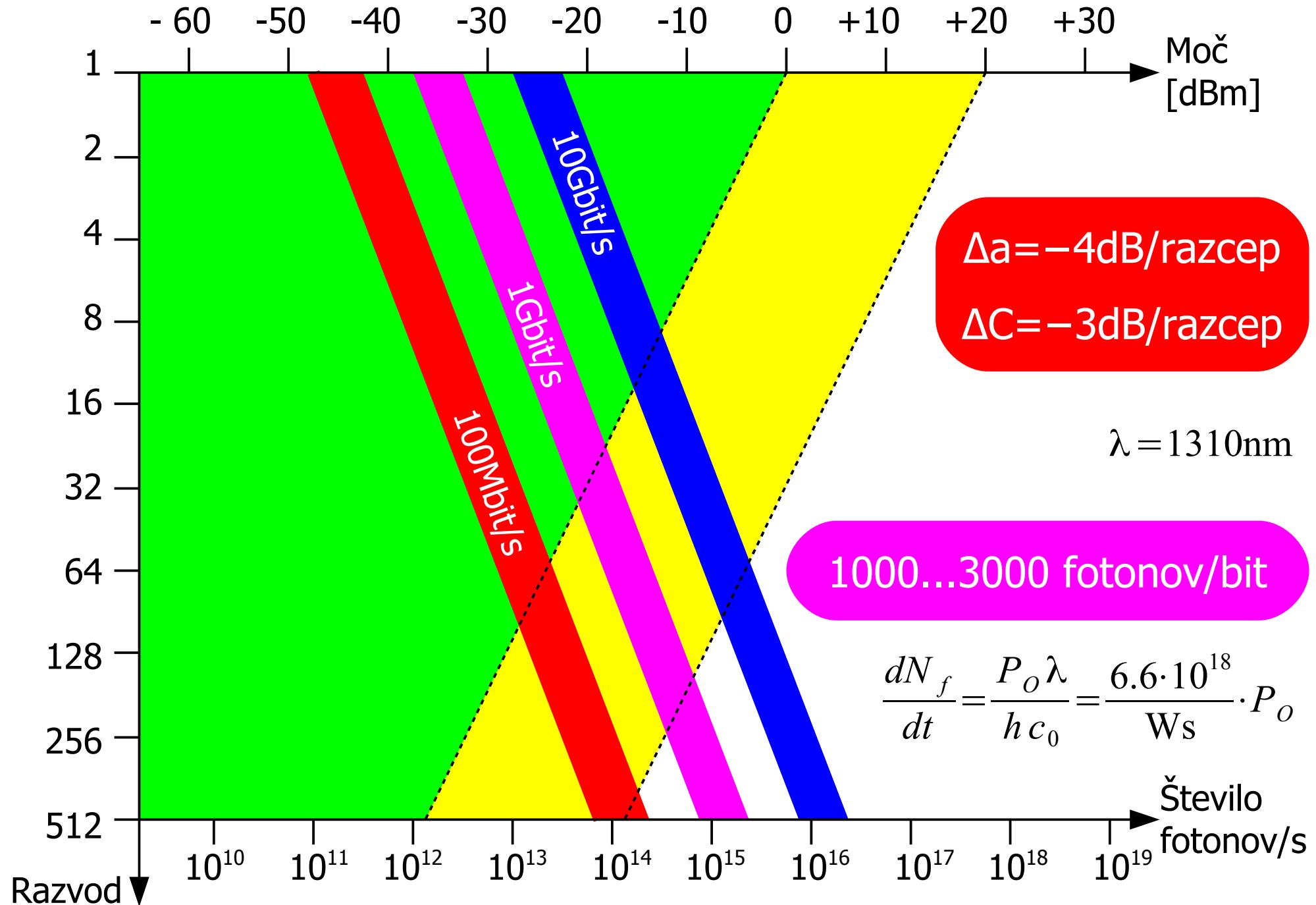
$$enica \rightarrow N_f \approx 2000$$



50% enic →

$N_f/\text{bit} \approx 1000 \text{ fotonov/bit}$





## Fotopomnoževalka

$$I_A = I_{FK} \cdot M^N$$

$$U_B \approx 100V$$

$$M \approx 3 \dots 5$$

$$N = 3 \\ (N = 8 \dots 14)$$

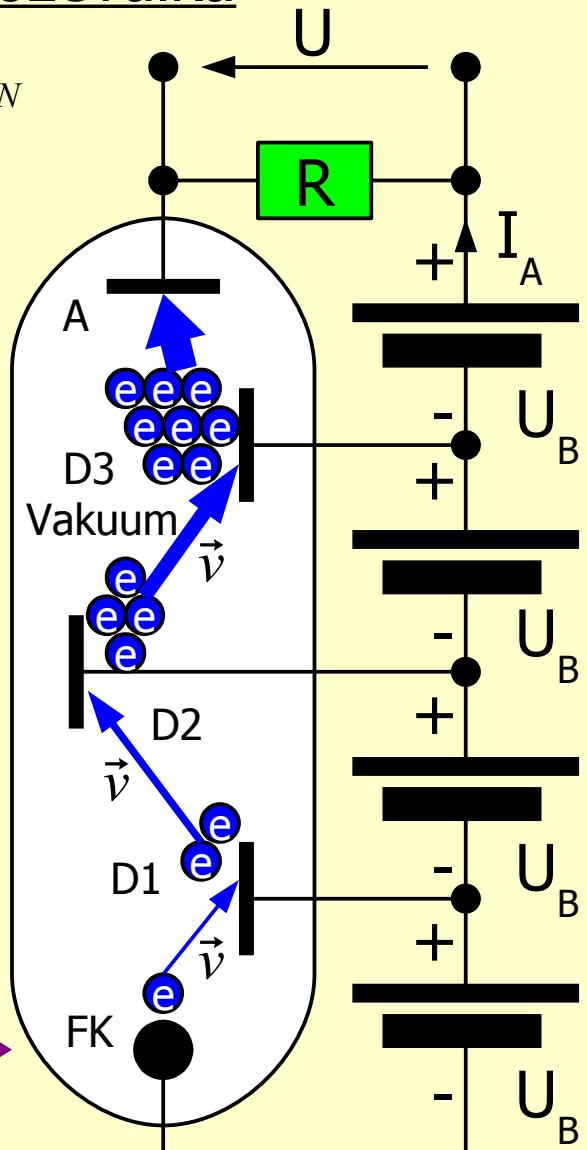
$$\tau \approx 1 \mu s$$

Svetloba

$$h\nu \geq W_i$$

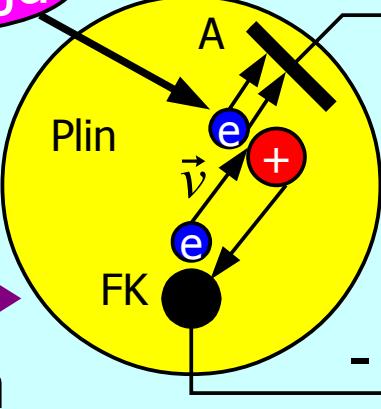
$$h\nu$$

$$\frac{N_{eFK}}{N_f} = \eta_{FK} \approx 10^{-6} @ 1550nm$$



## Plinska fotodioda

Ionizacija



Svetloba

$$h\nu \geq W_i$$

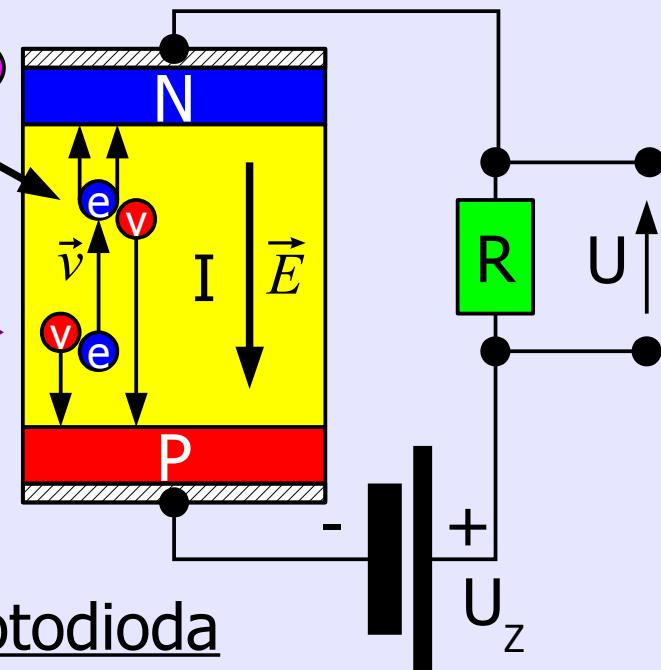
Ionizacija

$$h\nu$$

Svetloba

$$h\nu \geq \Delta W$$

## Plazovna fotodioda

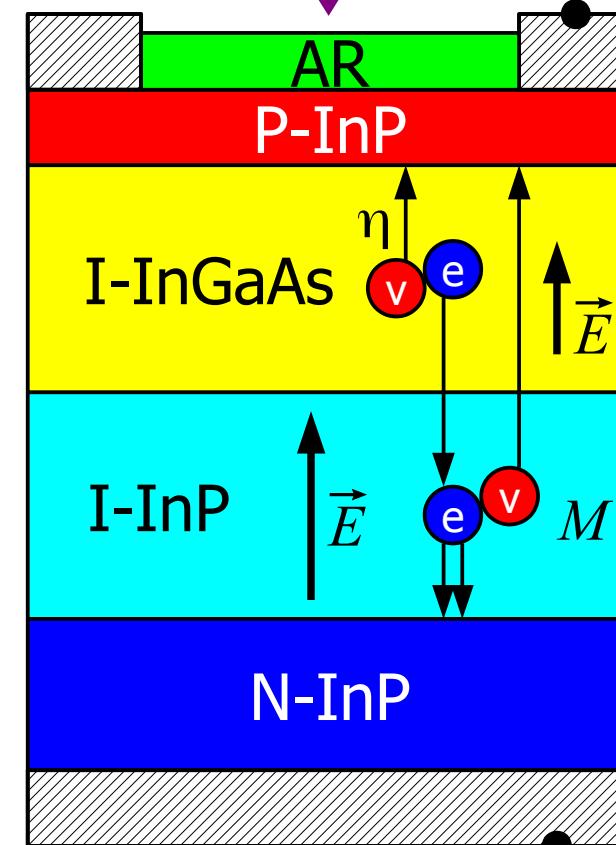


## Svetlobna moč

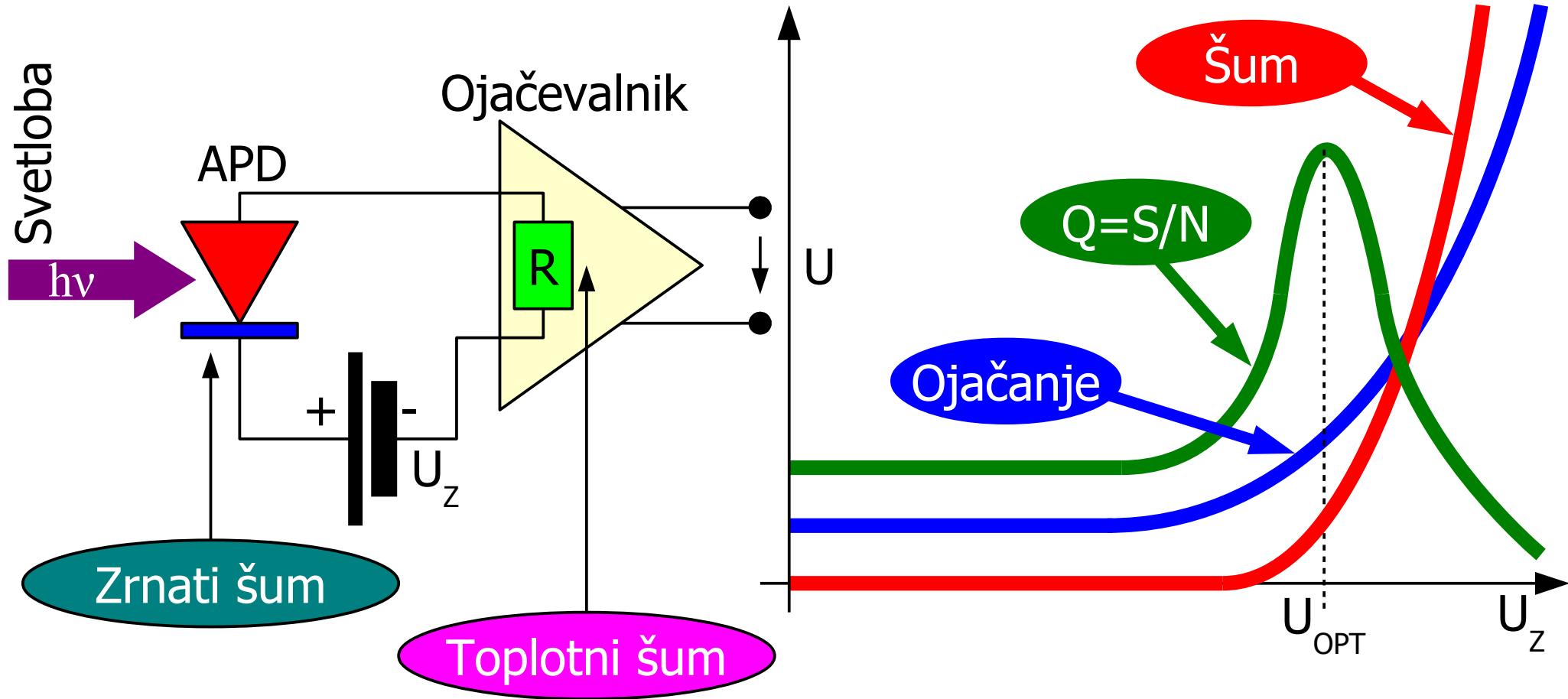
$$P_O = h\nu \cdot \frac{dN_f}{dt}$$



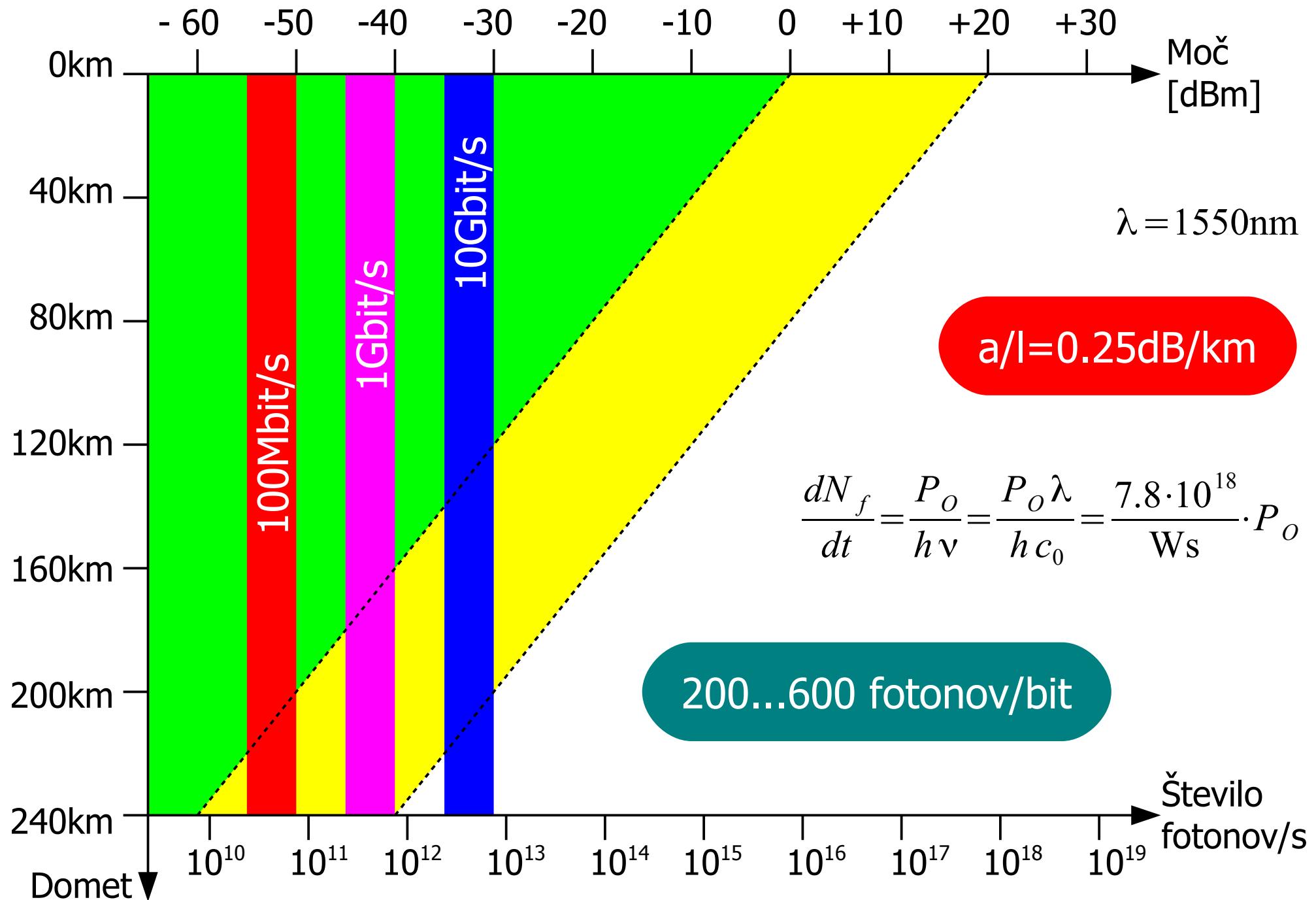
$$\text{Tok } I_E = |Q_e| \cdot \frac{dN_e}{dt} \cdot M$$

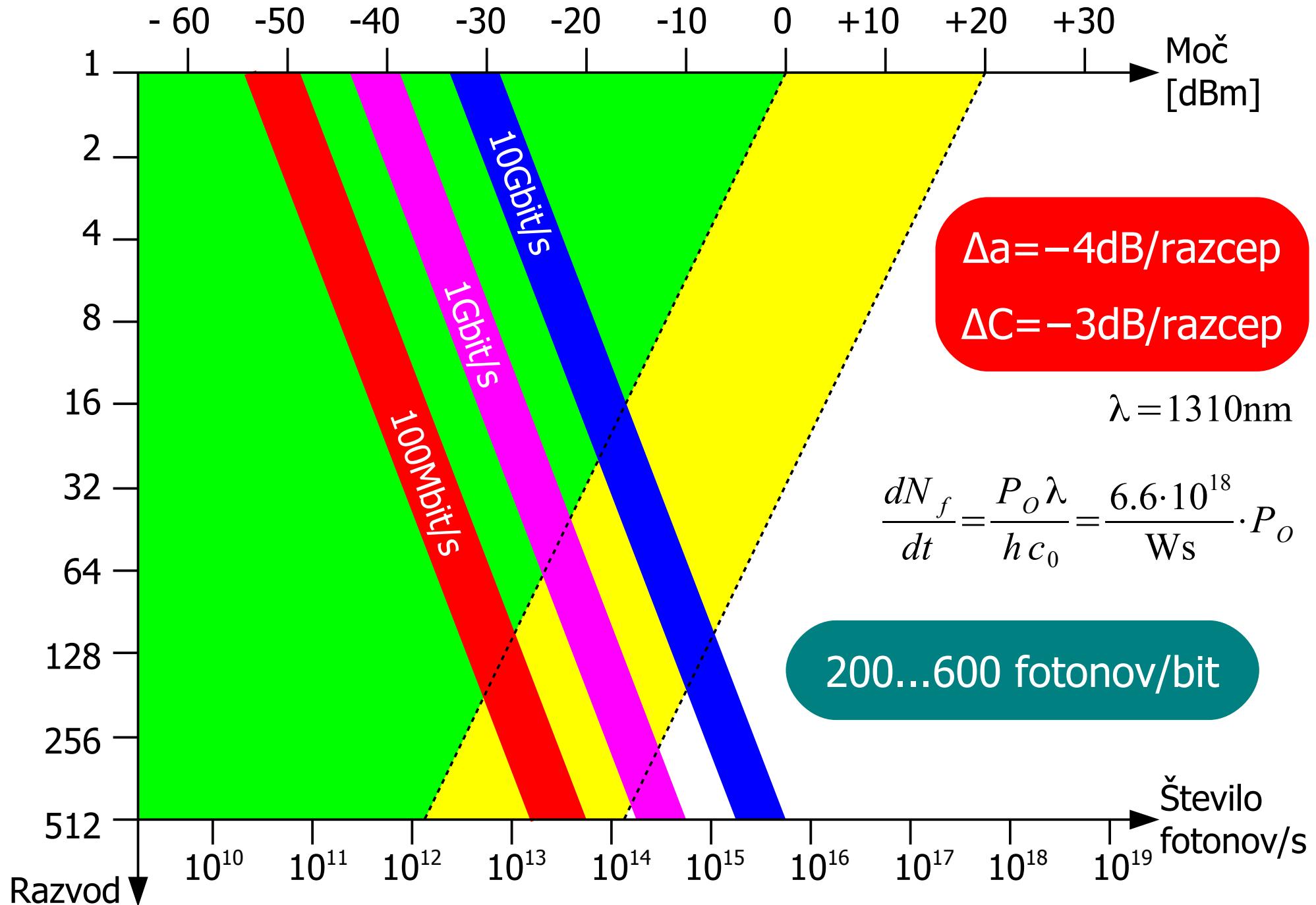


Heterostruktura InGaAs/InP

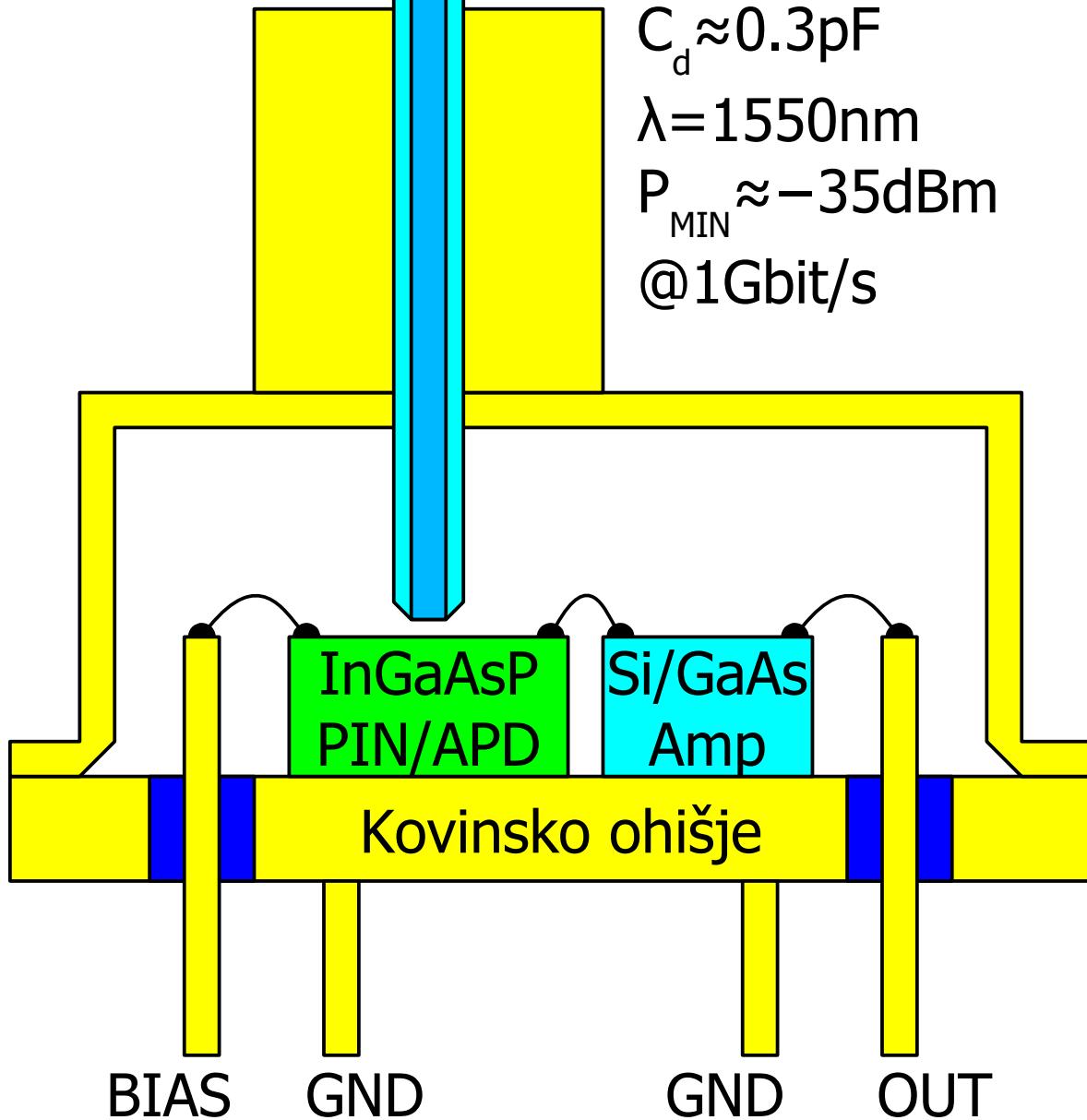


APD	$\Delta W$	$\lambda$	$h\nu$	$U_{OPT}$	$M_{OPT}$	Občutljivost
Si	1.11eV	850nm	1.46eV	~150V	~100	~60 fotonov/bit
Ge	0.67eV	1310nm	0.95eV	~30V	~10	~500 fotonov/bit
InGaAsP	~0.75eV	1550nm	0.80eV	~70V	~20	~200 fotonov/bit





Svetlobno  
vlakno



PIN-FET modul

$$A_d \approx 0.01\text{mm}^2$$

$$C_d \approx 0.3\text{pF}$$

$$\lambda = 1550\text{nm}$$

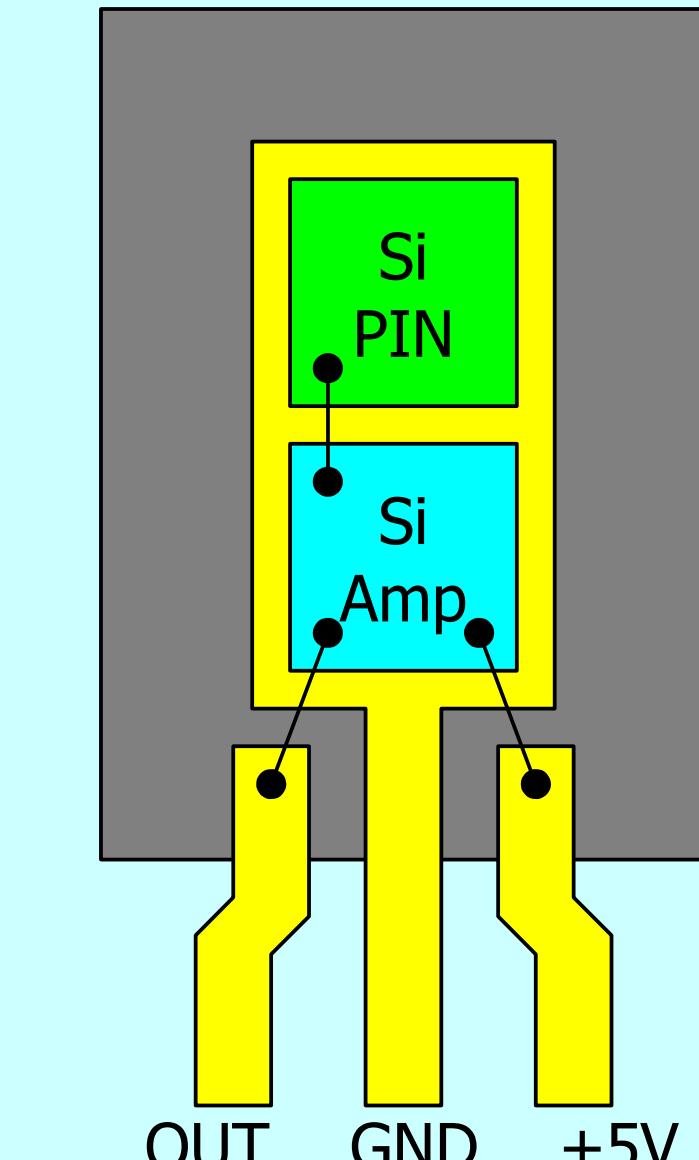
$$P_{\text{MIN}} \approx -35\text{dBm}$$

@1Gbit/s

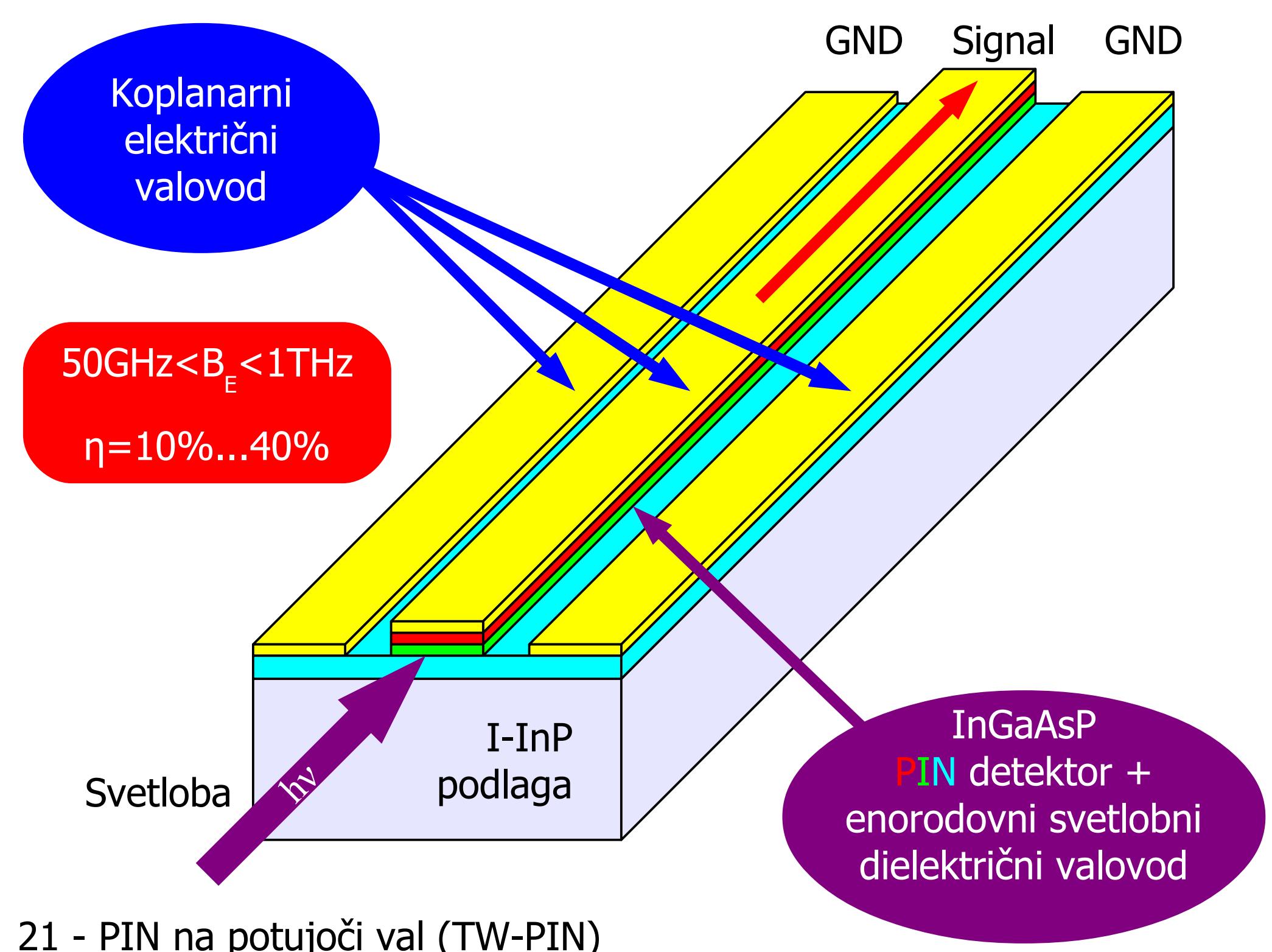
Sprejemnik IR daljinca

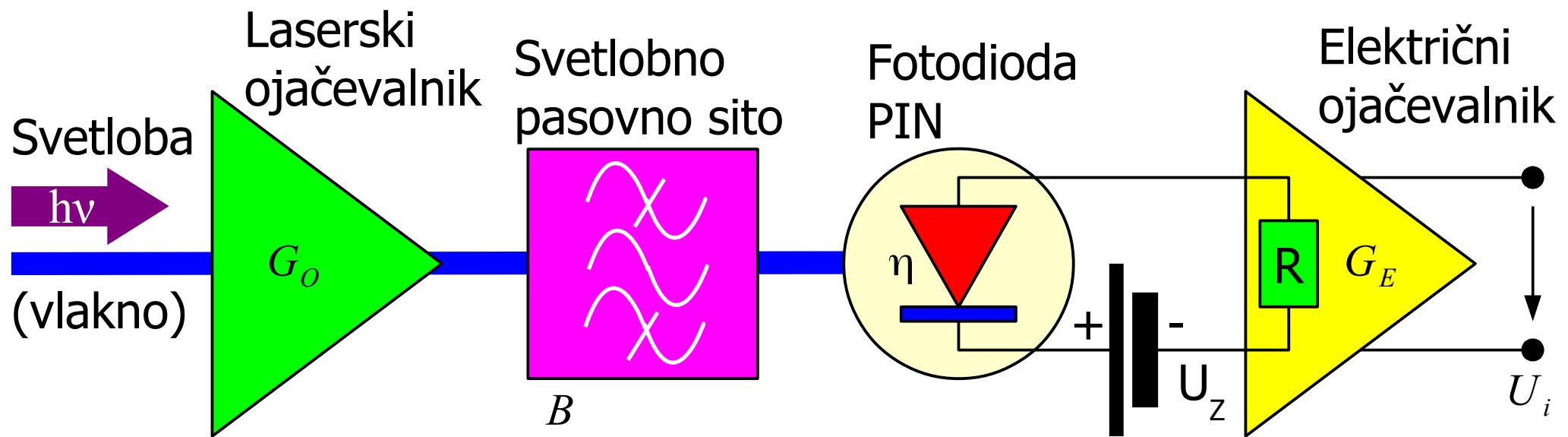
$$A_d \approx 1\text{mm}^2 \quad C_d \approx 30\text{pF}$$

$$S_{\text{MIN}} \approx 0.3\text{mW/m}^2 \quad @1\text{kbit/s}$$



Temna smola  $\equiv$  sito  $\lambda = 900\text{nm}$





### ASE šum predojačevalnika

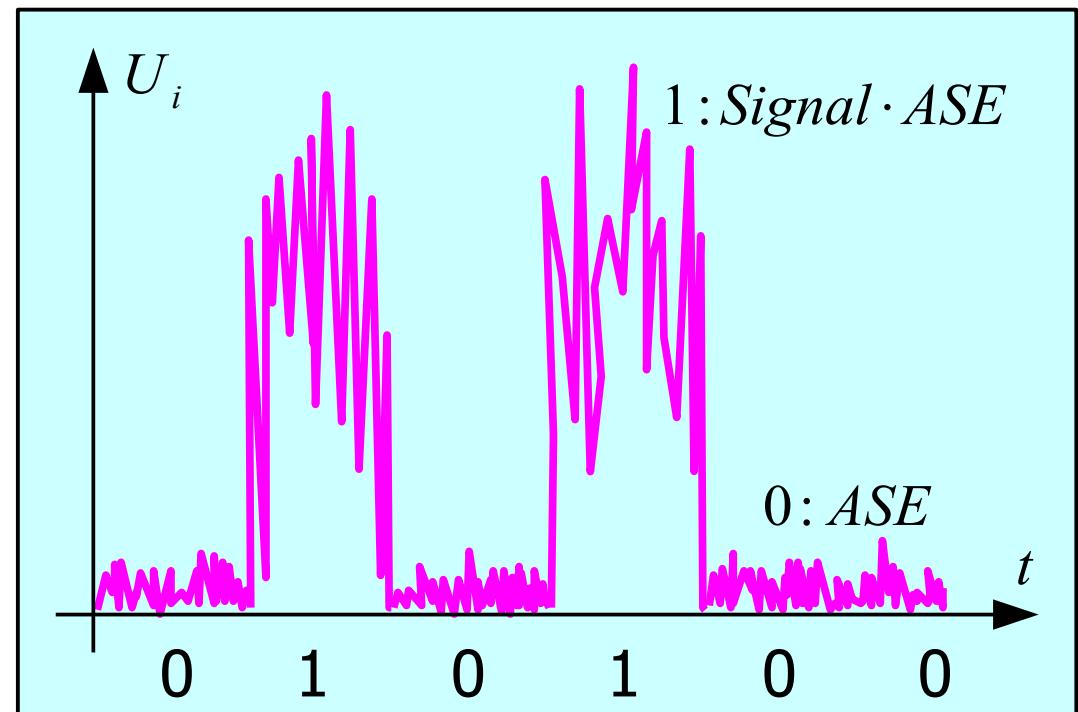
$$P_{ASE} = \mu \cdot (G_O - 1) \cdot h\nu \cdot B \quad N_0 = h\nu$$

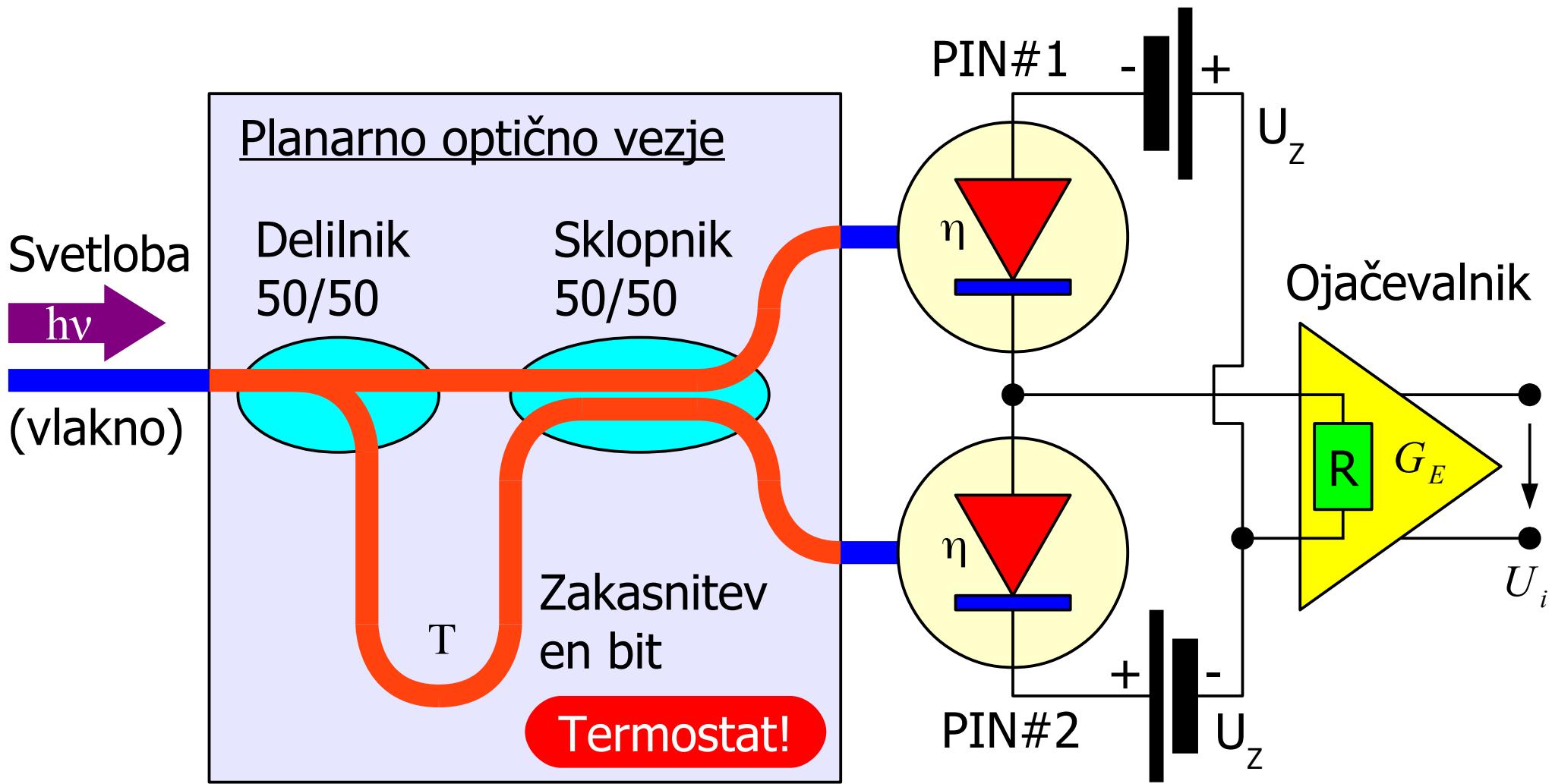
Faktor inverzne naseljenosti

$$\mu = \frac{N_2}{N_2 - N_1} \geq 1$$

$$P_{ASE} = \frac{N_2}{N_2 - N_1} \cdot (G_O - 1) \cdot \frac{hc_0}{\lambda} \cdot B$$

$N_f / \text{bit} \approx 45 \text{ fotonov/bit}$



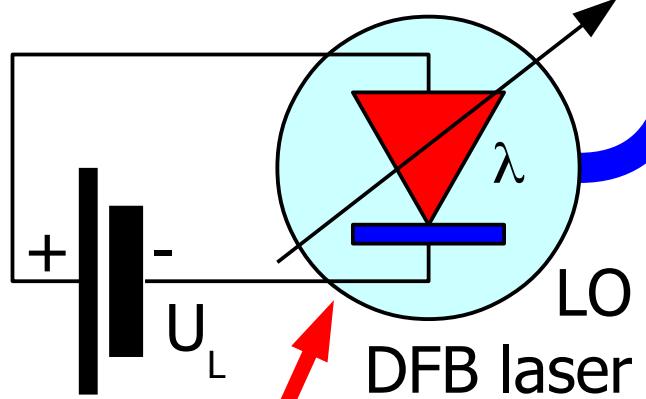
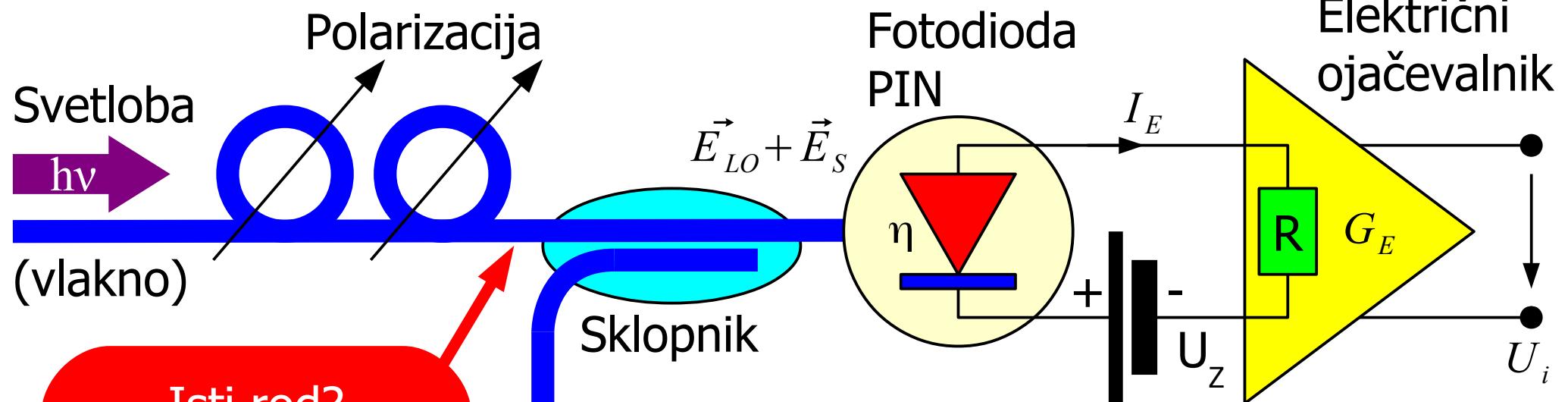


DPSK:

- konstantna ovojnica
- manjši učinek nelinearnosti

Zgled:  $C = 40 \text{ Gbit/s} \rightarrow T = 25 \text{ ns}$

Točnost frekvence:  $\Delta \nu \leq \frac{C}{10} \approx 4 \text{ GHz}$



Odstopanje frekvence?

Mešalni dobitek

$$\frac{I_{mešanje}}{I_{detektor}} = \frac{2 |E_{LO}|}{|E_S|}$$

Šum LO

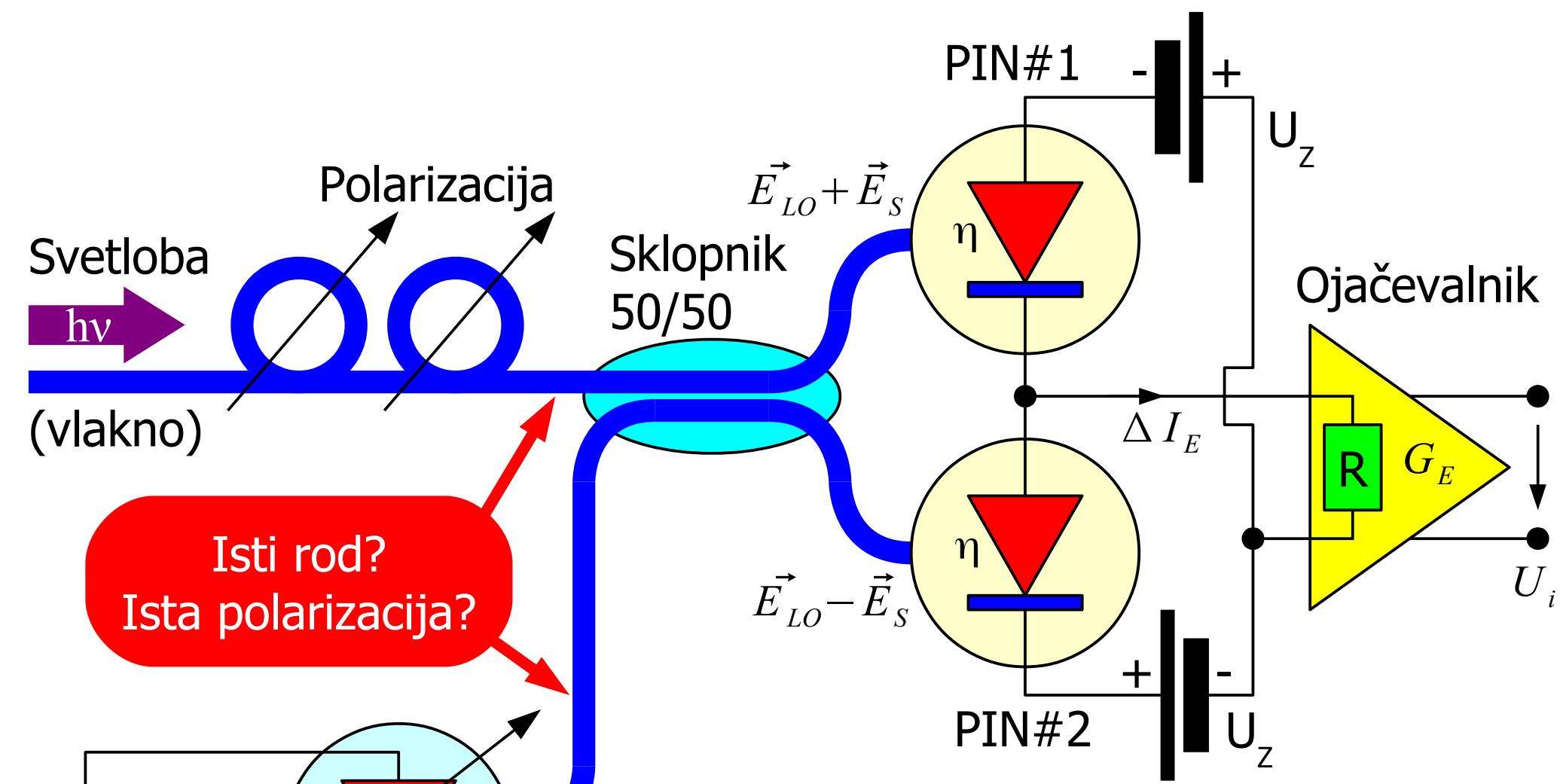
Detektor

Mešanje

1) Šum LO?

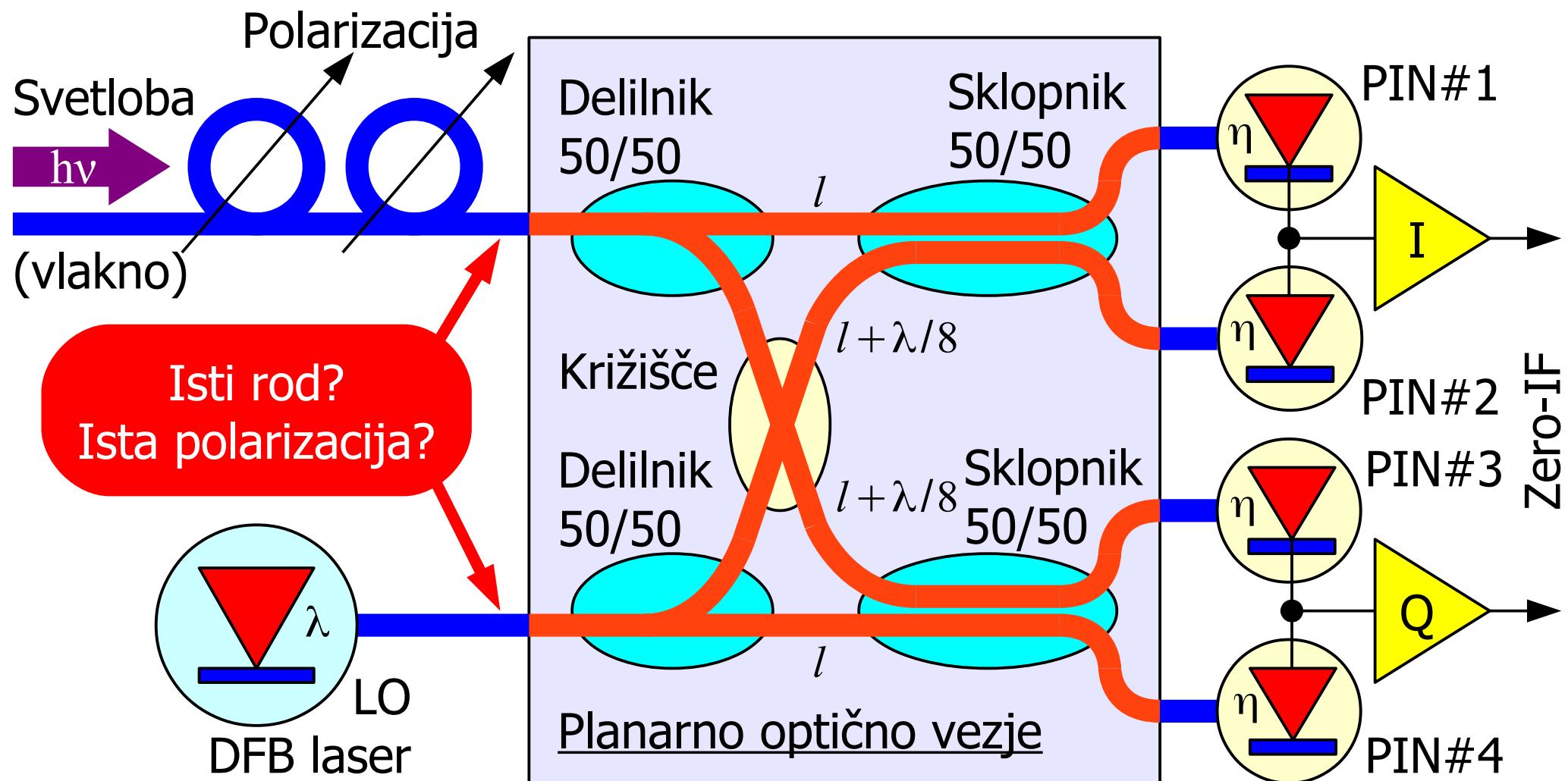
2) Odstopanje frekvence?

3) Ista polarizacija?

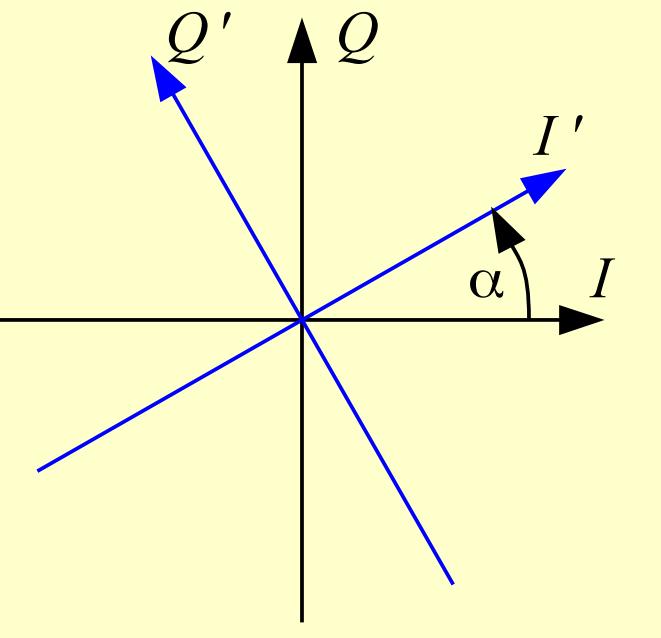


$$\Delta I_E = \alpha \left[ |\vec{E}_{LO} - \vec{E}_S|^2 - |\vec{E}_{LO} + \vec{E}_S|^2 \right]$$

- 1) Ni izgube signala v sklopniku!
- 2) Šum LO se natančno odšteje!



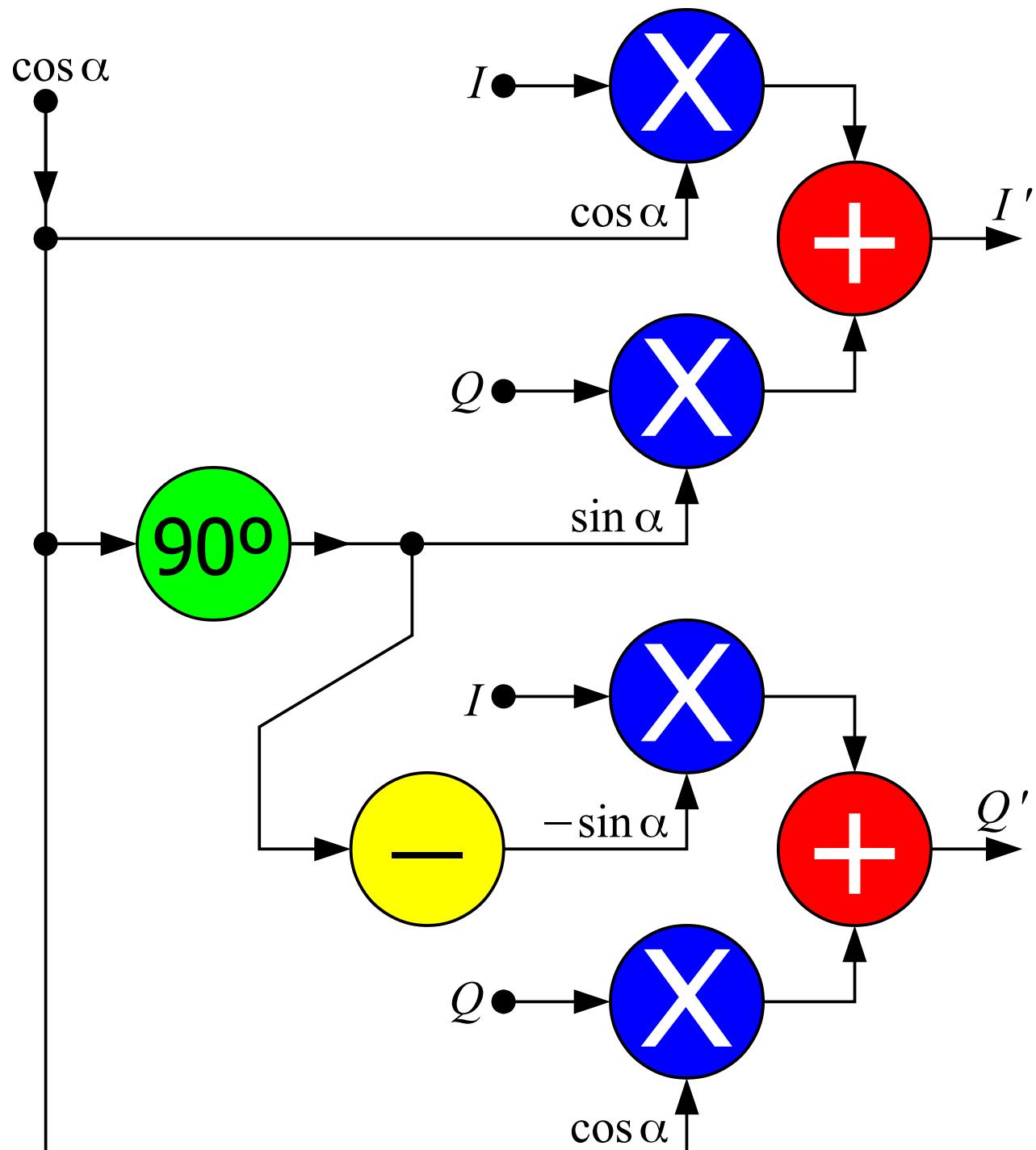
Stabilen DFB laser in sodobna hitra elektronika omogočata preslikavo odstopanja frekvence na električno ničelno medfrekvenco (Zero-IF)!

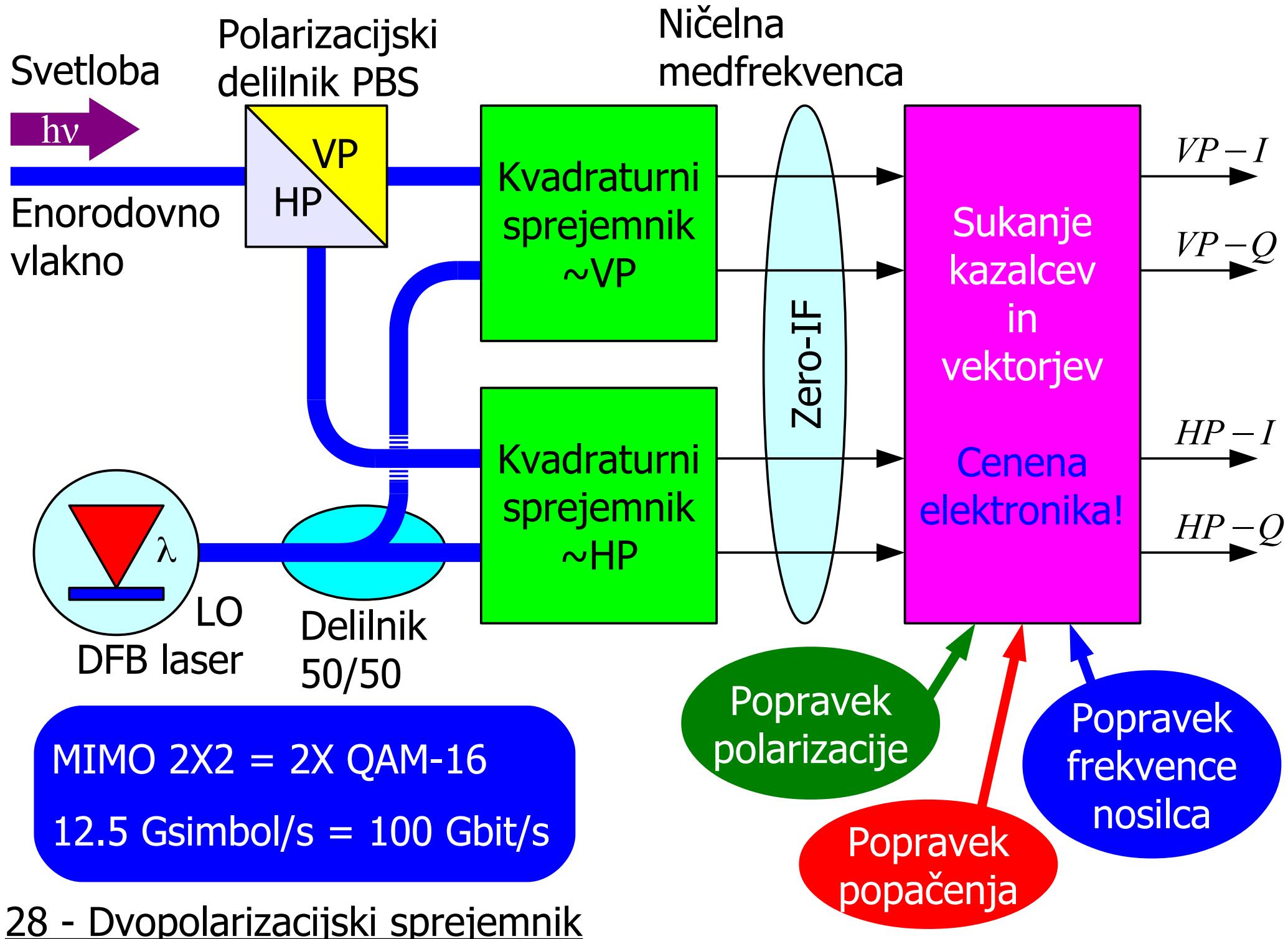


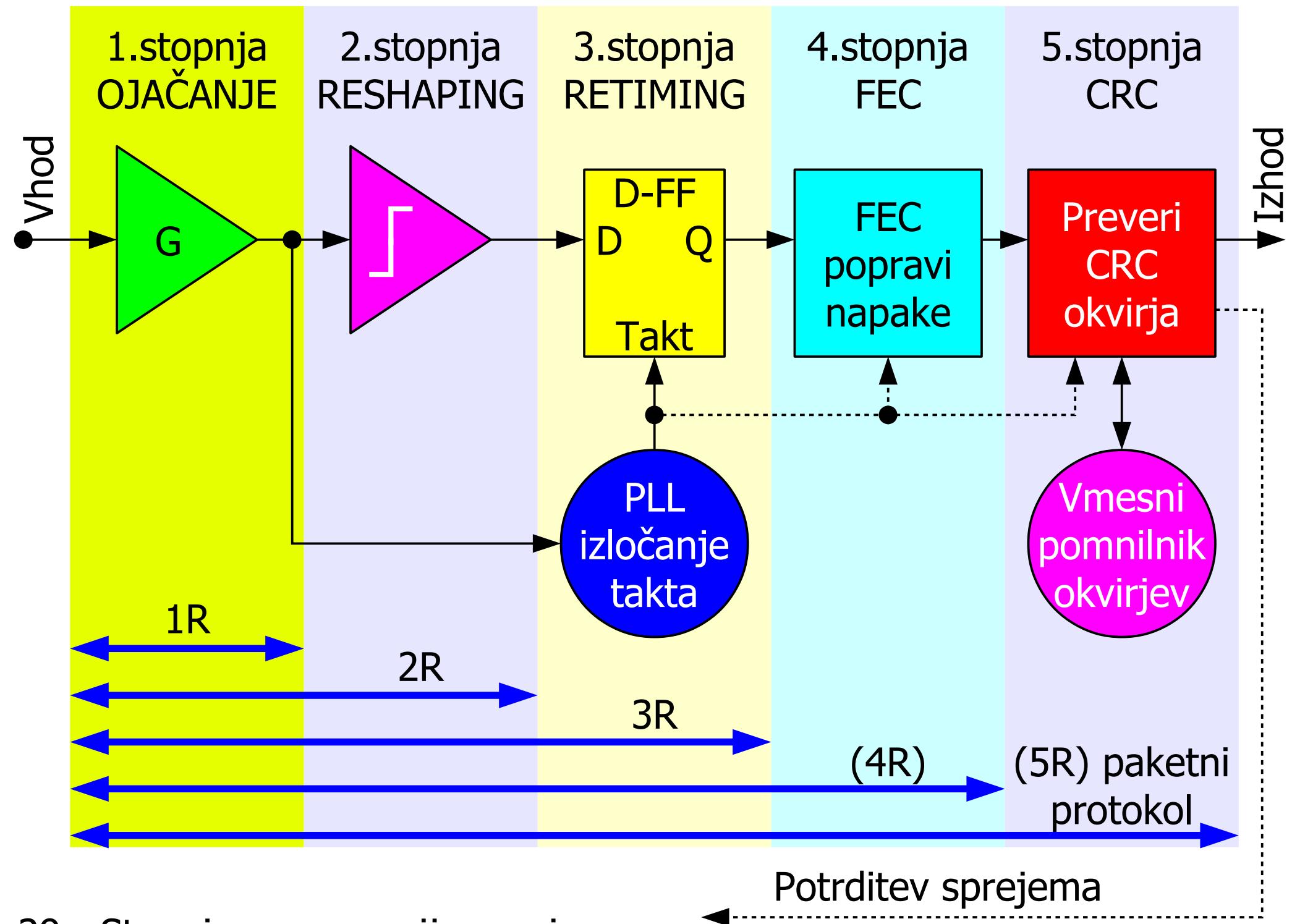
$$\begin{bmatrix} I' \\ Q' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I \\ Q \end{bmatrix}$$

Popravek frekvence:  
 $\alpha = \Delta\omega t$

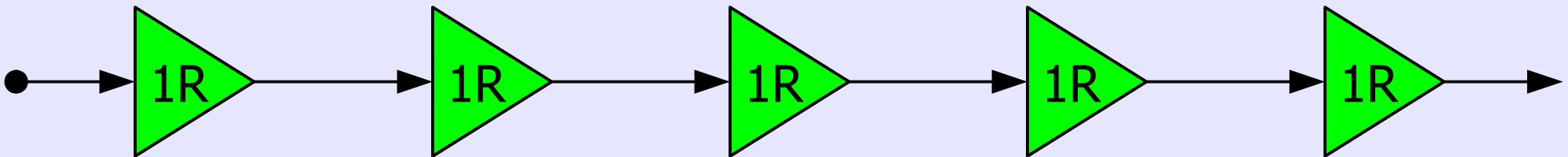
Popravek polarizacije:  
 $\alpha \equiv \text{zasuk}$





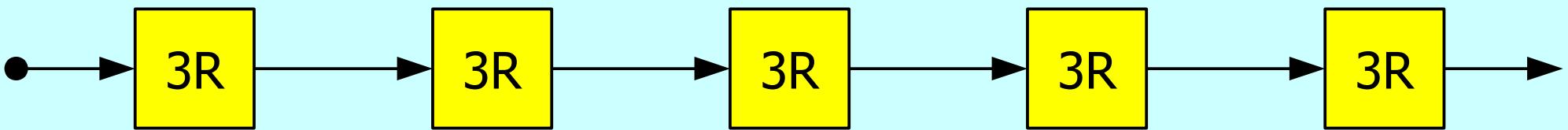


## Analogna zveza



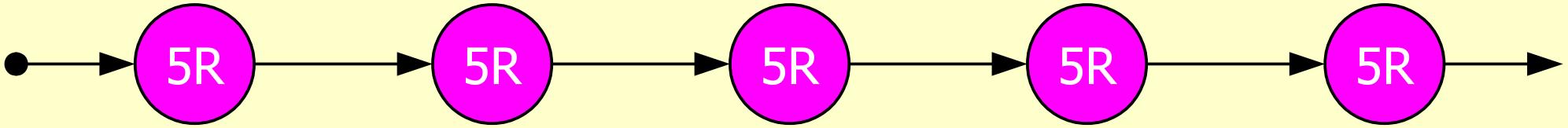
Seštevanje šuma! Presluh?

## Sinhrona zveza



Seštevanje drhtenja! Sinhronizacija spremenljivih poti?

## Paketna zveza



Uravnavanje pretoka? Nespoštovanje OSI ravni?